

02.12.2004

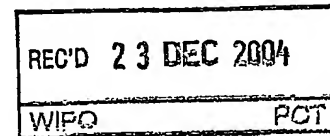
日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 3 年 1 1 月 2 8 日
Date of Application:

出 願 番 号 特 願 2 0 0 3 - 4 0 0 6 8 3
Application Number:
[ST. 10/C] : [J P 2 0 0 3 - 4 0 0 6 8 3]



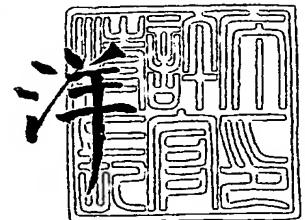
出 願 人 日 本 電 気 株 式 有 限 公 司
Applicant(s):

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2 0 0 4 年 1 1 月 4 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小 川



BEST AVAILABLE COPY

出 証 番 号 出 証 特 2 0 0 4 - 3 0 9 9 5 1 9

【書類名】 特許願
【整理番号】 34002341
【提出日】 平成15年11月28日
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 H01L 21/316
【発明者】
 【住所又は居所】 東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内
 【氏名】 原田 恵充
【発明者】
 【住所又は居所】 東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内
 【氏名】 林 喜宏
【発明者】
 【住所又は居所】 東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内
 【氏名】 伊藤 文則
【発明者】
 【住所又は居所】 東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内
 【氏名】 肱岡 健一郎
【発明者】
 【住所又は居所】 東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内
 【氏名】 竹内 常雄
【特許出願人】
 【識別番号】 000004237
 【氏名又は名称】 日本電気株式会社
【代理人】
 【識別番号】 100084250
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 丸山 隆夫
 【電話番号】 03-3590-8902
【手数料の表示】
 【予納台帳番号】 007250
 【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
 【物件名】 特許請求の範囲 1
 【物件名】 明細書 1
 【物件名】 図面 1
 【物件名】 要約書 1
 【包括委任状番号】 9303564

【書類名】 特許請求の範囲**【請求項 1】**

シリコン及び酸素を骨格とし側鎖に少なくとも一つの不飽和炭化水素基が結合された環状有機シリカ化合物の蒸気を含む気体をプラズマ中に導入し、半導体基板上に多孔質絶縁膜を成長させることを特徴とする多孔質絶縁膜の製造方法。

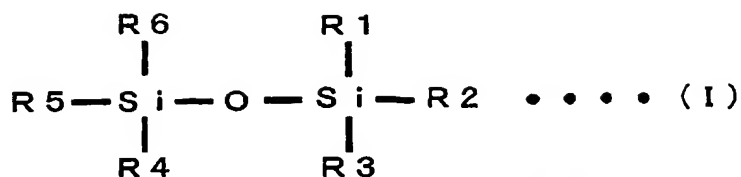
【請求項 2】

シリコン及び酸素を骨格とし側鎖に少なくとも一つの不飽和炭化水素基が結合された環状有機シリカ化合物の蒸気と、シリコン及び酸素を骨格とし側鎖に水素、炭化水素基及び酸化炭化水素基からなる群から選択されるいずれかが結合された直鎖状有機シリカ化合物の蒸気とをプラズマ中に導入し、半導体基板上に絶縁膜を成長させることを特徴とする多孔質絶縁膜の製造方法。

【請求項 3】

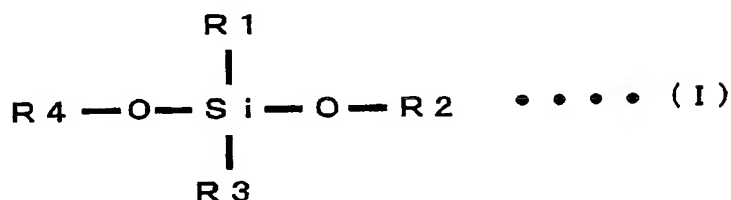
前記直鎖状有機シリカ化合物が、下記式 (I) で表される構造であることを特徴とする請求項 2 記載の多孔質絶縁膜の製造方法。

【化 1】



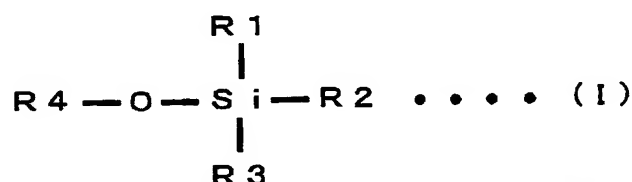
R 1 ～ R 6 は同一でも異なっても良く、水素、炭化水素基、酸化炭化水素基からなる群から選択されるいずれか一つを示す。

又は



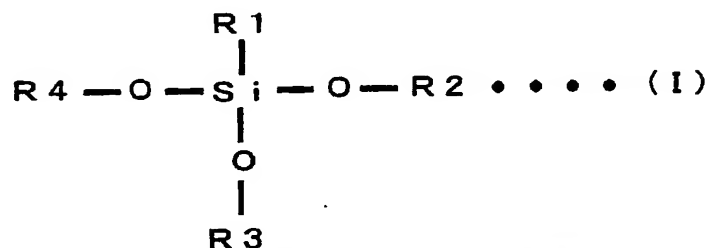
R 1 ～ R 4 は同一でも異なっても良く、水素、炭化水素基、酸化炭化水素基からなる群から選択されるいずれか一つを示す。

又は



R 1 ～ R 4 は同一でも異なっても良く、水素、炭化水素基、酸化炭化水素基からなる群から選択されるいずれか一つを示す。

又は



R 1 ～ R 4 は同一でも異なっても良く、水素、炭化水素基、酸化炭化水素基からなる群から選択されるいずれか一つを示す。

【請求項 4】

成膜途中で前記環状有機シリカ化合物と前記直鎖状有機シリカ化合物との供給比を変化させることを特徴とする請求項 2 又は 3 記載の多孔質絶縁膜の製造方法。

【請求項 5】

前記環状有機シリカ化合物が、下記式 (I I) で表されるシクロシロキサンモノマーであることを特徴とする請求項 1 から 4 のいずれか 1 項に記載の多孔質絶縁膜の製造方法。

【化 2】

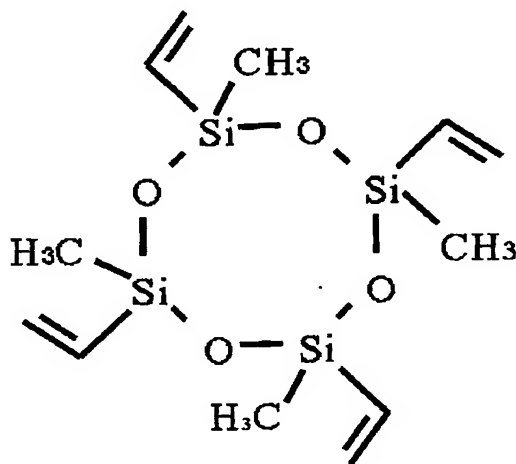


式 (I I) 中、各 R 1 及び R 2 はそれぞれ水素、アルキル基、アルコキシド基、アミノ基、アルケン、アルキン、フェニル基及びフェノール基からなる群から選択されるいずれか一つであり、各 R 1 及び R 2 は同一でも異なっても良い。ただし、側鎖基の少なくとも一つは不飽和炭化水素基である。また、n は 2 以上の整数である。

【請求項 6】

前記環状有機シリカ化合物が、下記式 (I I I) で示されるテトラビニルテトラメチルシクロテトラシロキサンモノマーであることを特徴とする請求項 1 から 4 のいずれか 1 項に記載の多孔質絶縁膜の製造方法。

【化 3】

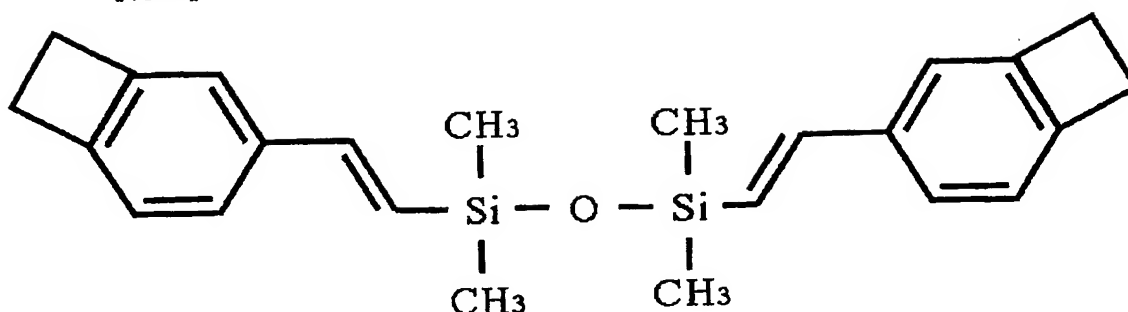


(I I I) テトラビニルテトラメチルシクロテトラシロキサン

【請求項 7】

前記環状有機シリカ化合物が、上記式 (I I I) で示されるテトラビニルテトラメチルシクロテトラシロキサンモノマーであり、前記直鎖状有機シリカ化合物が、下記式 (I V) で示されるジビニルシロキサンベンゾシクロブテンモノマーであることを特徴とする、請求項 2 から 4 のいずれか 1 項に記載の多孔質絶縁膜の製造方法。

【化 4】



(I V) ジビニルシロキサンベンゾシクロブテン

【請求項 8】

前記プラズマは、希ガス又はこれと酸化剤ガスとの混合気体のプラズマであることを特徴とする請求項 1 から 7 のいずれか 1 項に記載の多孔質絶縁膜の製造方法。

【請求項 9】

請求項 1 から 8 のいずれか 1 項に記載の多孔質絶縁膜の製造方法によって形成されたことを特徴とする多孔質絶縁膜。

【請求項 10】

膜中の元素存在比は、 $O/Si = 0.8 \sim 1.2$ であり、 $C/Si = 1.5 \sim 10.0$ であり、 $H/Si = 4.0 \sim 15.0$ であることを特徴とする請求項 9 に記載の多孔質絶縁膜。

【請求項 11】

膜中に含有される空孔径が 3 nm 以下であることを特徴とする請求項 9 又は 10 に記載の多孔質絶縁膜。

【請求項 12】

膜中に含有される空孔の少なくとも一部が、前記環状有機シリカ化合物の骨格と略同一径であることを特徴とする請求項 9 から 11 のいずれか 1 項記載の多孔質絶縁膜。

【請求項 13】

請求項 1 から 8 のいずれか 1 項に記載の多孔質絶縁膜の製造方法によって形成された多孔質絶縁膜を多層配線の層間絶縁膜として用いたことを特徴とする半導体装置。

【請求項 14】

請求項 4 に記載の多孔質絶縁膜の製造方法によって形成された多孔質絶縁膜と非多孔質絶縁膜との界面を有し、該界面近傍で少なくとも該多孔質絶縁膜中の炭素原子の相対濃度が段階的又は連続的に変化していることを特徴とする半導体装置。

【請求項 15】

前記直鎖状有機シリカ化合物が上記式 (I) で表される構造であることを特徴とする請求項 14 記載の半導体装置。

【請求項 16】

前記環状有機シリカ化合物が、上記式 (II) で表されるシクロシロキサンモノマー (式 (II) 中、各 R_1 及び R_2 はそれぞれ水素、アルキル基、アルコキシド基、アミノ基、アルケン、アルキン、フェニル基及びフェノール基からなる群から選択されるいずれか一つであり、各 R_1 及び R_2 は同一でも異なっても良い。ただし、側鎖基の少なくとも一つは不飽和炭化水素基である。また、 n は 2 以上の整数である。) であることを特徴とする請求項 14 記載の半導体装置。

【請求項 17】

前記環状有機シリカ化合物が、上記式 (III) で表されるテトラビニルテトラメチルシクロテトラシロキサンモノマーであることを特徴とする請求項 14 記載の半導体装置。

【請求項 18】

前記直鎖状有機シリカ化合物が、上記式 (I V) で表されるジビニルシロキサンベンゾシクロブテンモノマーであることを特徴とする請求項 14 から 17 のいずれか 1 項に記載の半導体装置。

【請求項 19】

前記プラズマは、希ガス又はこれと酸化剤ガスとの混合気体のプラズマであることを特徴とする請求項 13 から 18 のいずれか 1 項に記載の半導体装置。

【書類名】明細書

【発明の名称】多孔質絶縁膜及びその製造方法並びに多孔質絶縁膜を用いた半導体装置

【技術分野】

【0001】

本発明は、半導体装置を構成する絶縁膜として利用可能な多孔質絶縁膜及びその製造方法並びに多孔質絶縁膜を利用する半導体装置に関する。

【背景技術】

【0002】

近年の技術の発展に伴い、半導体装置の高集積化、高密度化が進んでいる。これに伴い、配線幅及び配線ピッチの微細化の進行による配線遅延の増大が顕在化している。

【0003】

配線遅延は配線抵抗と配線間容量との積に比例するが、上記のように配線幅の縮小に伴って配線抵抗が増大する傾向にあるため、配線間容量までもが増大すると、配線遅延が大幅に増大し、結果として回路の動作速度の劣化を招く。従って、半導体装置の動作速度向上のためには、低抵抗の配線材料及び低誘電率の層間絶縁膜の採用、並びにこれらを用いた半導体装置の製造プロセス技術の確立が求められている。

【0004】

従来、半導体集積回路の配線材料としては、アルミニウム又はアルミニウム合金が主に使用されていたが、より高速な動作を要求される集積回路においては、アルミニウムよりも抵抗率の低い金属である銅を配線材料として採用することで配線抵抗の低減を図っている。

【0005】

一方で、配線間容量の低減のためには、配線部を取り囲む絶縁膜の低誘電率化が必要である。このため、従来利用されてきた SiO_2 （比誘電率4）、 SiON （比誘電率4～6）、 Si_3N_4 （比誘電率7）等の無機系材料よりも比誘電率の低い絶縁膜材料を採用することが有効である。具体的には、低誘電率材料として、フッ素添加 SiO_2 （ SiOF ）や、炭素原子を含有する有機系絶縁膜材料などが利用されている。

【0006】

フッ素添加 SiO_2 は膜中のフッ素濃度を高くすることで比誘電率の低減を実現できる一方、吸湿性が増すという問題がある。また、水分や水素との反応によって生じるフッ化水素が原因で配線材の腐食が発生したり、フッ素の脱離による比誘電率の上昇といった問題が生じる。このため、フッ素添加 SiO_2 によって実質的に得られる比誘電率は3.3程度であり、比誘電率3以下を実現するのは難しい。

【0007】

一方、炭素原子を含有する有機系絶縁膜材料としては、有機SOG（spin on glass）、ポリイミドや、有機シランガスを用いた炭素添加 SiO_2 （以後、 SiOCH と記す）、あるいはこれらを多孔質化した絶縁膜（以後、多孔質膜と記す）等が挙げられる。この中でも特に多孔質絶縁膜は、膜中に空孔を含有することで比誘電率2.8以下を実現可能であり、90nm世代以降のULSI多層銅配線の層間絶縁膜として期待される材料の一つである。

【0008】

これら多孔質絶縁膜の成膜方法の一つに、スピン塗布法が挙げられる。スピン塗布法では、例えば原料のモノマーと空孔（ポア）形成剤とを混合した溶液をシリコン基板上にスピン塗布（回転させたシリコン基板の面上に溶液を滴下）することでシリコン基板上に被膜を形成する。その後、シリコン基板を350℃から450℃で加熱することで、その被膜中で熱重合反応と空孔形成剤の熱分解脱離反応とを起こさせることで、膜中に空孔を含有した多孔質絶縁膜を形成する。このスピン塗布法は、絶縁膜の形成方法として広く用いられている方法であるが、以下の課題を有している。

【0009】

スピン塗布法では、有機溶媒に溶かしたモノマー溶液をスピン塗布して均一化する。こ

のとき、用いた溶液の90%程度は基板外に飛ばされ、廃液となる。従って原料の利用効率は低く、製造コストが高くなる。

【0010】

また、スピン塗布法では、モノマーの重合反応及び硬化反応を起こすための加熱行程が必要となる。この加熱工程では、通常300℃～450℃程度の温度に保たれた炉内において、数十分から数時間にわたる熱処理を行うため、デバイス作製工程全体のスループットを低下する。また、加熱の際に雰囲気中に酸素分子が存在すると、これとモノマーとが反応してしまい目的とする膜構造が得られない場合がある。このため、加熱時の雰囲気中の酸素分子を除くために、ベーク炉全体を不活性ガスで置換する必要がある、このことは低コスト化を妨げる一因となりうる。

【0011】

さらに、多層配線の形成時には、各層毎に塗布及び加熱工程を行うため、最下層の配線層は繰り返し高温長時間の熱ストレスを受ける。これはデバイス信頼性、特に微細化された銅配線の劣化を誘発する一因となる。

【0012】

さらに、スピン塗布法で得られる多孔質絶縁膜は、その形成原理から膜表面につながる連続孔となる。より詳しく言えば、スピン塗布法の場合、膜中に含有した空孔形成剤を熱分解・脱離させた領域を空孔化するのであるが、そのためには空孔形成剤の熱分解・脱離ガスが膜中から外界（膜表面）へ抜けるためのガス抜き孔が必要となる。膜中の空孔は必ずガス抜き孔とつながっているため、膜表面につながる連続孔となる。すなわち、スピン塗布法の場合、熱反応を利用した絶縁膜の重合成長工程と多孔質化の過程とが分離独立しており、その多孔質絶縁膜は膜表面につながる連続孔から構成されてしまう。

しかし、膜表面につながる連続孔は、逆に、外気中の水分や半導体加工用のエッチングガスや洗浄水が膜内部に浸透拡散するための経路としても作用する。その結果、多孔質絶縁膜の特性が時間とともに変化し、不安定なものとなってしまう。

【0013】

多孔質絶縁膜を得る別の成膜方法としては、アモルファス絶縁膜を形成するプラズマCVD法が挙げられる。プラズマCVD法では、原料ガスをプラズマ中で解離・活性化しアモルファス絶縁膜を形成する。従って、原料の使用効率と言う点では塗布法よりも優れており、またスピン塗布に比べて薄膜化がしやすいなどの利点がある。また、塗布法と異なり、加熱による硬化工程を必要としないという利点を有している。

【0014】

しかしながら、上記のプラズマCVD法では、プラズマ中で出発原料ガスを原子レベルに解離させるため、原理的に出発原料の分子骨格を反映した構造が成長する訳ではない。例えば、直鎖状の有機シリカ分子をプラズマ中で解離させると、活性化した有機シリカ分子がシリコン基板へ到達する間にプラズマ気体中で一部結合し、基板上に“雪”が降り積もるがごとく嵩高い多孔質膜を形成させる。

【0015】

この場合、プラズマ中での活性原子の結合反応を促進するためには、活性原子の滞在時間を長くする必要がある。具体的には、基板とプラズマとの距離を十分に離すなどの工夫が必要である。しかしながら、プラズマ中での活性原子の成膜過程の制御は難しく、成長する多孔質絶縁膜構造の制御は困難と言える。すなわち、プラズマCVD法では、低誘電率化のために膜中に導入する空孔の大きさや充填率を、制御性良く実現することが本質的に難しい。また、出発原料を解離するために大きなプラズマパワーを必要するため、半導体デバイスへのプラズマダメージが大きいのといった課題がある。さらに、空孔径が3nm程度以上に大きくなると、水分、プロセスガス及び薬液等が絶縁膜中へ侵入したり、膜強度の低下等が生じやすく、結果として絶縁膜の信頼性劣化や、半導体デバイス作製プロセスへの適応性の低下を引き起こすといった問題を有する。

【0016】

また、多孔質絶縁膜を層間絶縁膜として利用する場合、これに接触する他の半導体材料

と高い密着性を有することが必要である。層間絶縁膜の低誘電率化を図るためには、膜中に含有される極性元素（酸素やシリコンなど）の比率を小さくすること、すなわち、膜中の有機基の比率を大きくすることが有効である。しかしながら、極性元素の比率を低減すると、他の半導体材料との界面において極性元素の面密度が低下することや、接触界面において組成が急激に変化する構造となってしまうことにより、結果として高い密着性を維持することが困難となる。

【0017】

絶縁膜の比誘電率を低くすることを目的とした発明としては、特許文献1に開示される「絶縁膜の形成方法および多層配線」がある。特許文献1に開示される発明は、半導体基板の表面にプラズマ重合ジビニルシロキサン・ビス・ベンゾシクロブテンを成長させて高耐熱性を有するベンゾシクロブテン膜を効率よく成膜できるようにしたものである。

【特許文献1】特開2001-230244号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0018】

しかし、特許文献1に記載の発明によって得られる絶縁膜は、環状構造を有する原料を出発原料としていないため、絶縁膜の密度を低く抑えることが難しい。また、特許文献1に記載の発明は、同一の原料を用いたとしても、どのような圧力下で絶縁膜を成長させたかによって、形成された絶縁膜の比誘電率が変化してしまう。すなわち、特許文献1に記載の発明では、同じ特性を有する絶縁膜を安定して得ることは難しい。

【0019】

このように、従来の技術では、比誘電率の低い絶縁膜を得ることはできるがそれを特定の値に制御することは難しかった。

【0020】

本発明はかかる問題に鑑みてなされたものであり、比誘電率の低い絶縁膜を安定して得ることのできる多孔質絶縁膜の製造方法、及びこの方法を用いて製造した多孔質絶縁膜並びにこの多孔質絶縁膜を層間絶縁膜として用いた半導体装置を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0021】

本発明者らは、上記の課題を解決すべく検討を重ねた結果、多孔質絶縁膜の成長法において、原料として、分子中に環状シリカ骨格を有し且つ該環状シリカ骨格に少なくとも一つの不飽和炭化水素基が結合されている有機シリカ化合物を用いてプラズマ重合反応または酸化剤ガスと反応させて、不飽和炭化水素結合を介した重合反応が支配的な成膜を行うことで、成膜される膜中に空孔を含有する、低誘電率な多孔質絶縁膜が形成可能であることを見出した。

【0022】

具体的には、上記目的を達成するため、本発明は、第1の態様として、シリコン及び酸素を骨格とし側鎖に少なくとも一つの不飽和炭化水素基が結合された環状有機シリカ化合物の蒸気を含む気体をプラズマ中に導入し、半導体基板上に多孔質絶縁膜を成長させることを特徴とする多孔質絶縁膜の製造方法を提供するものである。

【0023】

本発明の第1の態様にかかる多孔質絶縁膜の製造方法では、原料として、分子中に環状シリカ骨格を有し且つ該環状シリカ骨格に少なくとも一つの不飽和炭化水素基が結合されている有機シリカ化合物を少なくとも一種類用いてプラズマ重合反応又は酸化剤ガスとの反応を生じさせ、不飽和炭化水素結合を介した重合反応が支配的な成膜を行うことにより、プロセス安定性が高く且つ空孔制御が容易でしかも誘電率が低い多孔質絶縁膜の形成が可能となる。

【0024】

また、上記目的を達成するため、本発明は、第2の態様として、シリコン及び酸素を骨

格とし側鎖に少なくとも一つの不飽和炭化水素基が結合された環状有機シリカ化合物の蒸気と、シリコン及び酸素を骨格とし側鎖に水素、炭化水素基及び酸化炭化水素基からなる群から選択されるいずれかが結合された直鎖状有機シリカ化合物の蒸気とをプラズマ中に導入し、半導体基板上に絶縁膜を成長させることを特徴とする多孔質絶縁膜の製造方法を提供するものである。本発明の第2の態様においては、成膜途中で環状有機シリカ化合物と直鎖状有機シリカ化合物との供給比を変化させることが好ましい。

【0025】

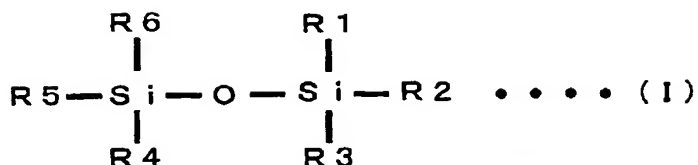
本発明の第2の態様にかかる多孔質絶縁膜の製造方法によれば、環状有機シリカ化合物と、直鎖状シリカ骨格に水素、炭化水素基及び酸化炭化水素基からなる群から選択されるいずれかが結合されている直鎖状有機シリカ化合物とを用いて、プラズマ重合反応又は酸化剤ガスとの反応を生じさせることで、低誘電率を維持したまま、膜中の炭素及び水素濃度を制御した多孔質絶縁膜の形成が可能となる。さらに、成膜工程中に、多孔質絶縁膜と、かかる多孔質絶縁膜に接する非多孔質絶縁膜との界面付近の炭素濃度を連続的又は段階的に制御して、接する半導体材料と高い密着性を得ることができる。

【0026】

上記本発明の第2の態様においては、直鎖状有機シリカ化合物が、下記式(I)で表される構造であることが好ましい。

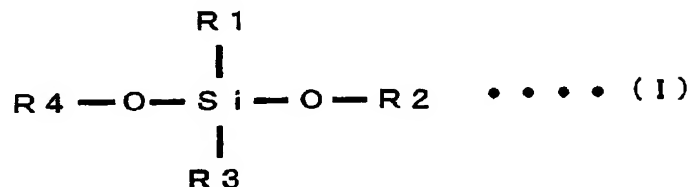
【0027】

【化5】



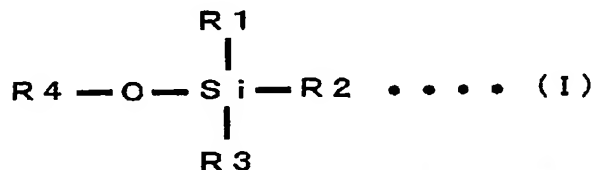
R1～R6は同一でも異なっても良く、水素、炭化水素基、酸化炭化水素基からなる群から選択されるいずれか一つを示す。

又は



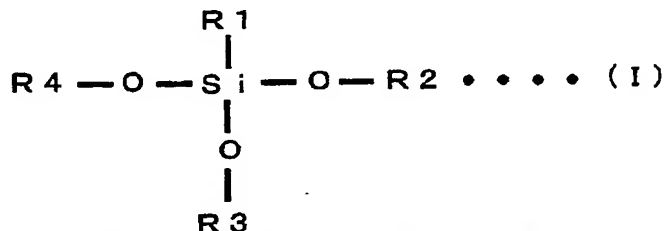
R1～R4は同一でも異なっても良く、水素、炭化水素基、酸化炭化水素基からなる群から選択されるいずれか一つを示す。

又は



R1～R4は同一でも異なっても良く、水素、炭化水素基、酸化炭化水素基からなる群から選択されるいずれか一つを示す。

又は



R1～R4は同一でも異なっても良く、水素、炭化水素基、酸化炭化水素基からなる群から選択されるいずれか一つを示す。

【0028】

上記本発明の第1の態様又は第2の態様においては、環状有機シリカ化合物が、下記式(I I)で表されるシクロシロキサンモノマーであることが好ましい。式(I I)中、各R₁及びR₂はそれぞれ水素、アルキル基、アルコキシド基、アミノ基、アルケン、アルキン、フェニル基及びフェノール基からなる群から選択されるいずれか一つであり、各R₁及びR₂は、同一でも異なっても良い。ただし、側鎖基の少なくとも一つは不飽和炭化水素基である。また、nは2以上の整数である。

【0029】

【化6】



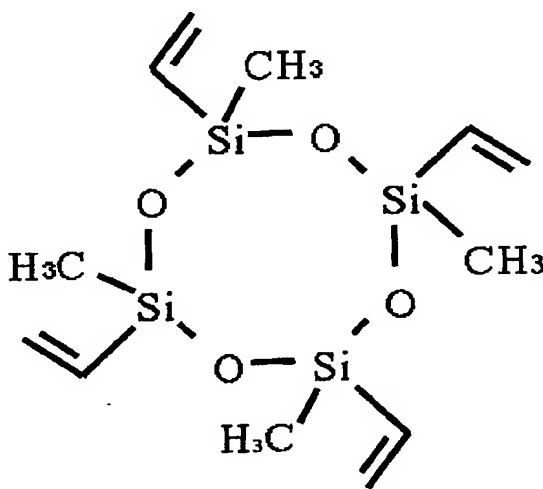
式 (I I) 中、各 R 1 及び R 2 はそれぞれ水素、アルキル基、アルコキシド基、アミノ基、アルケン、アルキン、フェニル基及びフェノール基からなる群から選択されるいずれか一つであり、各 R 1 及び R 2 は同一でも異なっても良い。ただし、側鎖基の少なくとも一つは不飽和炭化水素基である。また、n は 2 以上の整数である。

【0030】

又は、上記本発明の第 1 又は第 2 の態様においては、環状有機シリカ化合物が、下記式 (I I I) で示されるテトラビニルテトラメチルシクロテトラシロキサンモノマーであることが好ましい。

【0031】

【化7】



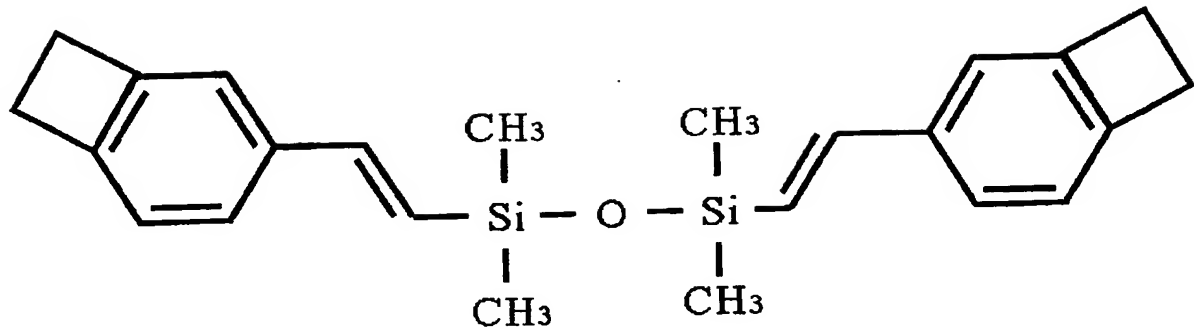
(I I I) テトラビニルテトラメチルシクロテトラシロキサン

【0032】

また、上記本発明の第 2 の態様においては、環状有機シリカ化合物が、上記式 (I I I) で示されるテトラビニルテトラメチルシクロテトラシロキサンモノマーであり、直鎖状有機シリカ化合物が、下記式 (I V) で示されるジビニルシロキサンベンゾシクロブテンモノマーであることが好ましい。

【0033】

【化 8】



(I V) ジビニルシロキサンベンゾシクロブテン

【0034】

上記本発明の第1の態様又は第2の態様のいずれの製造方法においても、プラズマは、希ガス又はこれと酸化剤ガスとの混合気体のプラズマであることが好ましい。

【0035】

また、上記目的を達成するため、本発明は、第3の態様として、上記本発明の第1の態様又は第2の態様にかかる多孔質絶縁膜の製造方法によって形成されたことを特徴とする多孔質絶縁膜を提供するものである。本発明の第3の態様においては、膜中の元素存在比は、 $O/Si = 0.8 \sim 1.2$ であり、 $C/Si = 1.5 \sim 10.0$ であり、 $H/Si = 4.0 \sim 15.0$ であることが好ましい。また、膜中に含有される空孔径が3 nm以下であることが好ましい。また、膜中に含有される空孔の少なくとも一部が、環状有機シリカ化合物の骨格と略同一径であることが好ましい。

【0036】

また、上記目的を達成するため、本発明は、第4の態様として、上記本発明の第1又は第2の態様にかかる多孔質絶縁膜の製造方法によって形成された多孔質絶縁膜を多層配線の層間絶縁膜として用いたことを特徴とする半導体装置を提供するものである。

【0037】

また、上記目的を達成するため、本発明は、第5の態様として、上記本発明の第2の態様にかかる多孔質絶縁膜の製造方法において成膜途中で環状有機シリカ化合物と直鎖状有機シリカ化合物との供給比を変化させて形成した多孔質絶縁膜と非多孔質絶縁膜との界面を有し、該界面近傍で少なくとも該多孔質絶縁膜中の炭素原子の相対濃度が段階的又は連続的に変化していることを特徴とする半導体装置を提供するものである。本発明第5の態様においては、直鎖状有機シリカ化合物が上記式(I)で表される構造であることが好ましい。また、環状有機シリカ化合物が、上記式(II)で表されるシクロシロキサンモノマーであることが好ましい。また、環状有機シリカ化合物が、上記式(III)で表されるテトラビニルテトラメチルシクロテトラシロキサンモノマーであることが好ましい。また、直鎖状有機シリカ化合物が、上記式(IV)で表されるジビニルシロキサンベンゾシクロブテンモノマーであることが好ましい。また、プラズマは、希ガス又はこれと酸化剤ガスとの混合気体のプラズマであることが好ましい。

【0038】

上記本発明の第5の態様では、多孔質絶縁膜とこれに接する非多孔質絶縁膜との界面付近の炭素濃度を制御した絶縁膜を多層銅配線の層間絶縁膜として導入することで、配線の寄生容量を低減し、高速かつ低電力動作の半導体装置が実現される。

【0039】

〔作用〕

本発明にかかる多孔質絶縁膜の形成方法は、多孔質絶縁膜を上記の半導体装置を構成する層間絶縁膜として利用する際、かかる層間絶縁膜中に制御性良く微細な空孔を導入する

過程が容易であり、また絶縁膜の比誘電率の低減が可能である。さらに、多孔質絶縁膜と、かかる多孔質絶縁膜に接する非多孔質絶縁膜との界面付近の炭素濃度を制御して、高い密着性を得ることができる。

また、本発明にかかる半導体装置は、構造安定性や密着性に優れた多孔質絶縁膜を多層銅配線の層間絶縁膜として導入することで、配線の寄生容量を低減し、高速かつ低電力動作を実現する。

【発明の効果】

【0040】

本発明によれば、比誘電率の低い絶縁膜を安定して得ることのできる多孔質絶縁膜の製造方法、及びこの方法を用いて製造した多孔質絶縁膜並びにこの多孔質絶縁膜を層間絶縁膜として用いた半導体装置を提供できる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0041】

【発明の原理】

本発明は、上記の課題を解決するための多孔質絶縁膜の成膜方法に係り、原料として分子中に環状シリカ骨格を有し、且つ該環状シリカ骨格に少なくとも一つの不飽和炭化水素基が結合されている環状有機シリカ化合物を用いて、該環状有機シリカ化合物の蒸気を低パワープラズマ中に導入することで、環状シリカ骨格を保ったまま不飽和炭化水素を選択的に活性化させる。環状有機シリカ化合物にはシリカ骨格で囲まれた微細空孔が存在するが、この不飽和炭化水素から形成される炭化水素基を介して別の環状有機シリカ分子と重合反応させると、あたかもシリカ骨格で囲まれた微細空孔が三次元空間に連なった多孔質絶縁膜が形成される。

【0042】

原料として分子中に少なくとも一つの不飽和炭化水素結合を有し、且つモノマー中に分子空孔を有する有機シリカ化合物をプラズマ中に導入すると、該有機シリカ化合物はプラズマ中で分解されるが、不飽和炭化水素結合を有していることから、未結合手を1本以上有するラジカルが生成されやすい。従って、これらラジカルの重合反応が支配的な成膜が進み、この結果として、不飽和炭化水素結合を含まない環状シリカ化合物に比し、高い成膜速度を得ることが可能である。

【0043】

また、環状有機シリカ同士を重合させる以外に、例えば不飽和炭化水素の結合した直鎖状有機シリカと該環状有機シリカ化合物との混合ガスをプラズマ中に導入すれば、環状シリカ骨格内の微細空孔が直鎖状有機シリカを介して重合された多孔質絶縁膜が形成される。Si原子に対する相対炭素濃度が、環状有機シリカ化合物に比して高い直鎖状有機シリカ化合物を用いれば、炭素成分により富んだ多孔質絶縁膜が形成される。成膜中に環状有機シリカ分子ガスと直鎖状有機シリカ分子ガスとの供給比を変化させれば、成長膜厚方向に炭素組成の変化した多孔質絶縁膜が得られる。

【0044】

ここで肝要なことは、該環状シリカ骨格を破壊させることなく、かつこれに結合する不飽和炭化水素基を優先的に活性化させるプラズマが必要不可欠である。希ガス、He、Ne、Ar、Krのプラズマは不飽和炭化水素の選択活性に有効である。さらに、我々は、この希ガスに酸化剤ガスを混ぜた混合ガスのプラズマが不飽和炭化水素基の選択活性化を促進させ、多孔質絶縁膜の成長速度を著しく向上させる新現象を見いだした。正確な促進反応機構は現時点でわかっていないが、不飽和炭化水素基中の炭素の一部が酸素と結合してCO又はCO₂として引き抜かれ、後に残った炭素ラジカルを介して環状有機シリカ化合物が重合してゆくものと推測される。

【0045】

以上の述べた本願発明による多孔質絶縁膜の製造方法においては、その多孔質源として出発原料たる環状有機シリカ化合物中の微細空孔を用い、この微細空孔を不飽和炭化水素の誘導体を介して結合してゆくことが特徴である。従って、得られた多孔質絶縁膜中の

空孔径は、出発原料中の環状シリカ骨格内部の微細空孔径とほぼ一致したものが主を占める。

【0046】

上記の構成を有する本発明の多孔質絶縁膜の製造方法に用いる環状有機シリカ化合物は、上記式 (I I) で表されるシクロシロキサンモノマー (式 (I I) 中、各 R_1 及び R_2 はそれぞれ水素、アルキル基、アルコキシド基、アミノ基、アルケン、アルキン、フェニル基及びフェノール基からなる群から選択されるいずれか一つであり、各 R_1 及び R_2 は同一でも異なっても良い。ただし、側鎖基の少なくとも一つは不飽和炭化水素基である。また、 n は 2 以上の整数である。) である

【0047】

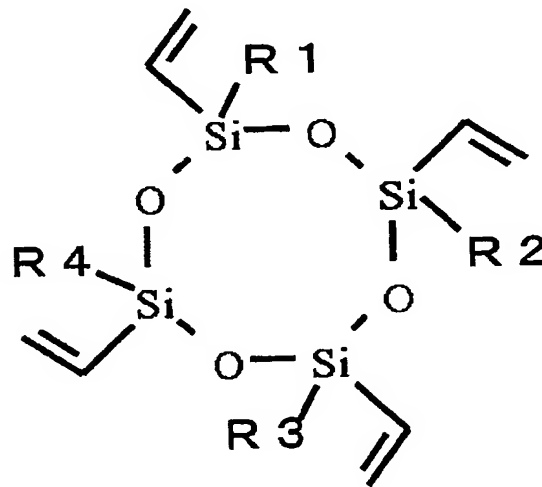
具体的には、 $n = 4$ で表される前記有機シリカ化合物は、上記式 (I I I) で示されるテトラビニルテトラメチルシクロテトラシロキサンモノマーである。

【0048】

また、このほかにも、下記一般式 (V) で示されるテトラビニルシクロテトラシロキサン誘導体 (式 (V) 中、 R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 は同一でも異なっても良く、水素、アルキル基、アルコキシド基、アミノ基、アルケン、アルキン、フェニル基、フェノール基などを示す) を用いることもできる。

【0049】

【化9】



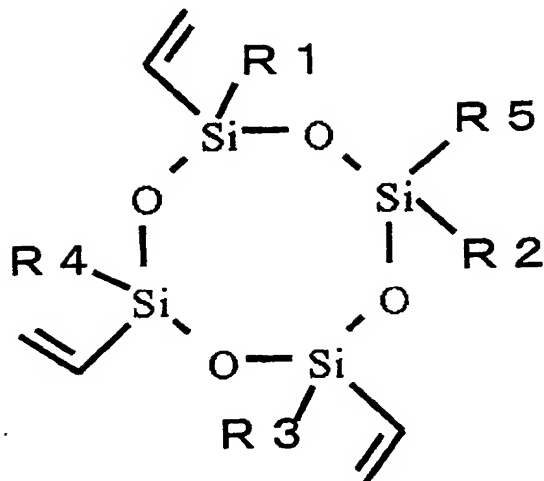
(V) テトラビニルシクロテトラシロキサン誘導体

【0050】

さらに、下記一般式 (V I) で示されるトリビニルシクロテトラシロキサン誘導体 (式 (V I) 中、 R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_5 は同一でも異なっても良く、水素、アルキル基、アルコキシド基、アミノ基、アルケン、アルキン、フェニル基、フェノール基などを示す) を用いることもできる。

【0051】

【化10】



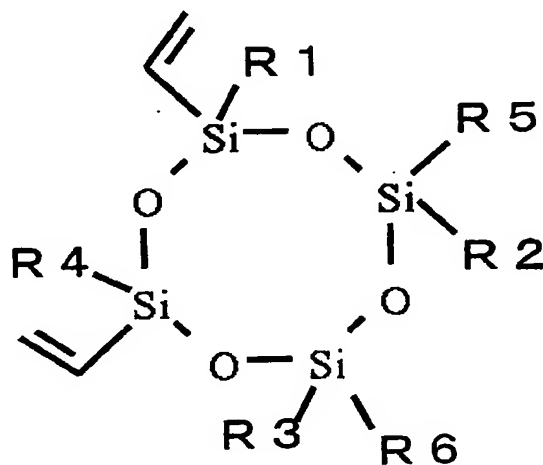
(V I) トリビニルシクロテトラシロキサン誘導体

【0052】

また、下記一般式 (V I I) で示されるジビニルシクロテトラシロキサン誘導体 (式 (V I I) 中、R1、R2、R3、R4、R5、R6 は同一でも異なっても良く、水素、アルキル基、アルコキシド基、アミノ基、アルケン、アルキン、フェニル基、フェノール基などを示す) を用いることもできる。

【0053】

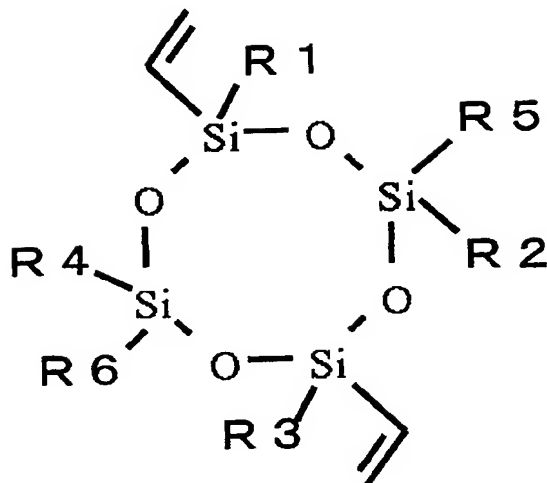
【化11】



(V I I) ジビニルシクロテトラシロキサン誘導体

【0054】

【化 1 2】



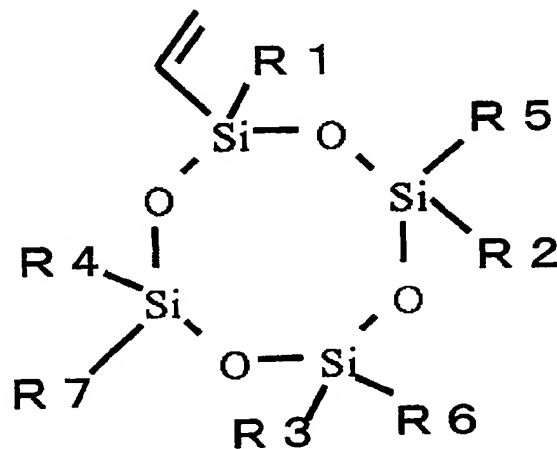
(V I I) ジビニルシクロテトラシロキサン誘導体

【0055】

また下記一般式 (V I I I) で示されるビニルシクロテトラシロキサン誘導体 (式 (V I I I) 中、R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7は同一でも異なっても良く、水素、アルキル基、アルコキシド基、アミノ基、アルケン、アルキン、フェニル基、フェノール基などを示す) を用いることもできる。

【0056】

【化 1 3】



(V I I I) ビニルシクロテトラシロキサン誘導体

【0057】

同様にして、ペンタビニルシクロテトラシロキサン誘導体、ヘキサビニルシクロテトラシロキサン誘導体、ヘプタビニルシクロテトラシロキサン誘導体、オクタビニルシクロテトラシロキサン誘導体としても良い。

【0058】

また、原料となる有機シリカ化合物を構成する環状シリカ骨格は、 $n=4$ の8員環に限らず、4員環 ($n=2$)、6員環 ($n=3$)、10員環 ($n=5$)、あるいはそれ以上の n であっても構わなく、また、それらは少なくとも一つの不飽和炭化水素結合を有してい

いればよい。

【0059】

さらに、上記の環状有機シリカ化合物原料を、単一で用いても十分な効果が得られるものであるが、これらの環状有機シリカ化合物を複数組み合わせ用いても、多孔質絶縁膜を成長することができる。さらには、不飽和炭化水素を含む環状有機シリカ化合物と、側鎖に水素、炭化水素基及び酸化炭化水素基からなる群から選択されるいずれかが結合された直鎖状有機シリカ化合物とを組み合わせ用いることもできる。

【0060】

次に、本発明の実施の形態に係る半導体装置の製造方法に用いられる成長装置（成膜装置）の一例を図1に示す。

反応室1は、排気配管7、排気バルブ22及び冷却トラップ8を介して接続された真空ポンプ9により減圧されている。反応室1の内部には基板保持台を兼ねた基板加熱部3が設けられ、基板加熱部3上に半導体基板（被成膜基板）2が敷置される。

【0061】

原料であるモノマーは気化システム16a内において気化され、気化された分子蒸気はキャリアガスとともにバルブ21aを介して配管15を通じ、反応室1へ供給される。二種のモノマーを原料として用いる場合は、これに加えて、気化システム16bを用いて気化した分子蒸気を、キャリアガスとともにバルブ21bを介して配管15へ送り、配管15内で二種のモノマーの分子蒸気を混合し、反応室1に供給すれば良い。また、三種類以上の原料を用いる場合には、同様にして、複数の原料タンク（図示しない）、原料供給配管（図示しない）、気化供給システム（図示しない）、気化原料供給配管（図示しない）などを同様にして設置すれば良い。

【0062】

さらに、配管15にはバルブ20及び流量コントローラ18を介して酸化剤ガス、希釈ガス、パージガス及びクリーニングガスが導入可能となっており、必要に応じて、気化された分子蒸気への酸化剤ガスの添加や、不活性ガスによる希釈が行われる。

【0063】

クリーニングガスは、反応室1の付着生成物を除去するために用いられ、通常、 O_2 とフロロカーボンガスとの混合気がよく使用されるが、付着生成物を除去する効果のあればこれらに限定されるものではない。また、クリーニングガスの代わりに、 NF_3 などを用いたりモートプラズマシステムを利用してもよい。

【0064】

酸化剤ガスとしては、 O_2 、 CO_2 、 CO 、 N_2O 、 NO_2 などを用いることができる。この他に、 H_2O も酸化作用を有するが、 H_2O を用いた場合は、膜中に $Si-OH$ 基が形成される。この $Si-OH$ 結合に含まれる $-OH$ 基は、多層配線形成時の熱処理プロセス中に熱の影響を受けたり、ガス成分と反応することにより、 $Si-OH$ 基同士での反応や、エッチングガス中に含まれる水素との反応を起こし、 H_2O を生じる。膜中に残留した H_2O を脱離させるには、 $100^\circ C$ 以上での熱処理などが施されるが、これは工程数の増加すなわちコストの増加とスループットの低下を招く。

【0065】

また、膜中に残留した H_2O は熱処理によって膜中から脱離するが、脱離と同時に膜の収縮を生じる。さらに、膜中に H_2O が水分子の形で残留した場合、 H_2O の比誘電率は約80であることより、膜の比誘電率の大幅な上昇を招く。従って、酸化剤として H_2O を用いることは好ましくない。

【0066】

希釈ガスとしては、 He 、 Ar 、 Ne 、 Xe などを用いることができる。

【0067】

配管15は、分子蒸気の分圧が配管温度における平衡蒸気圧よりも低くなるようにヒータ19によって加熱・保温され、分子蒸気の再液化を防止している。また、配管15は反応室1のパージ不活性ガスの経路としても用いられる。

【0068】

反応室 1 に導入された分子蒸気、キャリアガス、酸化剤ガス及び希釈ガスは、複数の貫通孔を有し反応室 1 内に設置されたシャワーヘッド 4 で混合及び分散されたのち、半導体基板（被成膜基板）2 上に吹き付けられる。シャワーヘッド上部には図示しないガス分散板が設けられることもある。

【0069】

シャワーヘッド 4 には、給電線 11 とマッチングコントローラ 12 とを介して RF 電源 13 が接続され、接地線 6 を介して接地された基板加熱部 3 との間に RF 電力が供給される。

半導体基板 2 上に吹き付けられた分子蒸気は、シャワーヘッド 4 と基板加熱部 3 との間にかかる印加電力によって誘起されたプラズマにより励起・活性化され、基板加熱部 3 上に置かれた半導体基板 2 の表面に吸着する。活性化され半導体基板 2 上に吸着した分子蒸気は、プラズマエネルギーと基板加熱部 3 より与えられる熱エネルギーとによって重合反応を起こし、半導体基板 2 上に絶縁膜を形成する。

【0070】

なお、反応生成物の付着を防止する目的で、反応室 1 の外壁はヒータ 5 によって、排気配管 7 はヒータ 23 によって加熱されている。また同様の理由で、シャワーヘッドには図示しないヒータが具備されることもある。

【0071】

未反応の分子蒸気は排気バルブ 22 と排気配管 7 とを通じて冷却トラップ 8 に導入される。冷却トラップ 8 では、トラップ面の温度が十分低いため、分子蒸気はその表面に凝集し、冷却トラップ 8 内部で液化及び固化を生じる。その結果、未反応の分子蒸気は冷却トラップ 8 内にて回収される。結果として、真空ポンプ 9 には原料が取り除かれたキャリアガス、酸化剤ガス、希釈ガス等の添加ガス、及びクリーニングガスのみが送られる。

【0072】

また、原料として用いるモノマーの蒸気圧がテトラエトキシシラン（TEOS）などに比して小さい場合、大容量気化のため及び気化された原料の再液化を防止するためには、気化システム 16a（16b）から反応室 1 までの圧力損失を小さくすることが重要となる。圧力損失を小さくするには、例えば、気化システム 16a（16b）出口～反応室 1 までの配管径を圧力損失を十分小さくできる範囲に設定すればよい。具体的に言えば、気化システム 16a（16b）～反応室 1 までに配管径 1/4～3/8 インチ程度の配管を用いていたのであれば、これを 1/2 インチ以上とする（配管径を大きくする）ことで圧力損失を低減できる。

【0073】

また、気化器システム 16a（16b）～反応室 1 までの配管径を大きくした場合、図 1 に示したシャワーヘッド 4 と、配管 15 との間の電位差により、配管 15 の内部にもプラズマが誘起されやすくなり、結果として反応室 1 上部のガス導入部付近及び配管 15 内部に、反応生成物が付着する。これを防止するためは、配管 15 が金属製の場合にはガス導入部付近にアルミナなどの絶縁材を設けて、配管 15 と反応室 1 上部との絶縁性を強化することや、配管 15 内部を絶縁材でコーティングすることが非常に効果的である。また、配管材質を金属ではなく絶縁材（例えばアルミナ）とすることも有効である。

【0074】

図 2 は、図 1 中で示した気化システム 16a、16b に関する模式的な説明図である。ここでは、原料であるモノマーが液体である場合を示している。

なお、以下の説明では単量体であるモノマーについて説明するが、ダイマー、オリゴマーについてもその原理は同様である。また、原料が気体である場合は、流量コントローラ等により流量を制御し、反応室 1 へ供給すれば良い。

【0075】

原料タンク 25 に充填されたモノマー 24 は、供給配管 27、バルブ 42、流量指示器 32 及びバルブ 46 を介して、気化制御器 35 へ導入される。一方、キャリアガス 26 は

流量コントローラ 34、バルブ 47 及び配管 53 を経て気化制御器 35 内に導入される。気化制御器 35 に導入された原料 24 は、気化制御器 35 内に設けられ、流量指示器 32 からフィードバック制御されるバルブ 48 を介し、気化制御器 35 内の配管 36 においてキャリアガス 26 と混合され、バルブ 50 を介して気化室 37 に導入される。

【0076】

気化室 37 は減圧されており、さらにヒータ 38 により加熱されているため、気化室 37 内へ導入された原料 24 はこの熱エネルギーによって連続的に気化する。

【0077】

気化した原料 24 は、ヒータ 38 によって加熱され、ガス温度を保ったまま、キャリアガス 26 とともに、ヒータ 40 で保温された配管 30、バルブ 51 及び配管 39 を通じて反応室 1 へ供給される。なお、流量コントローラ 34、バルブ 47 及び配管 30 は、気化制御器 35 内部配管 36、バルブ 50、気化室 37、及び気化室出口配管 39、バルブ 51、バルブ 52、ベント配管 41 のパージ用にも用いる。

【0078】

図 3 は、原料が固体の場合、原料の分子蒸気を発生させ、供給する気化供給システムの構成を模式的に示す図である。

キャリアガス 53 は、流量コントローラ 54、バルブ 55、配管 56 を介して原料タンク 58 に供給される。原料タンク 58 は、固体原料 59 を内蔵しており、またヒータ 57 によって、固体原料 59 が熔融状態から気化して、あるいは固相状態から昇華して、十分な飽和蒸気圧が得られる温度に加熱されている。

【0079】

気化した原料の分子蒸気はキャリアガス 53 とともに、配管 60、バルブ 61、流量コントローラ 62 及びバルブ 63 を介して気化原料供給配管 64 に供給され、バルブ 66 及び配管 67 を介して反応室 1 に供給される。

【0080】

また、気化する原料は、モノマー、ダイマー、オリゴマーいずれの原料についても同様の原理で気化が可能である。さらに、本発明において、キャリアガスにはヘリウムガス、アルゴンガス、ネオンガス等、気化させる原料に対して不活性なガスを適宜使用することができる。

【0081】

以上のように、原料は常温で固体、液体、気体いずれの状態においても、適切な気化供給システムを選択することで、目的とする供給量の原料の分子蒸気を反応室へ供給することができる。

【0082】

次に、上記原理に基づく本発明の好適な実施の形態を示すことにより、本発明をより具体的に説明する。なお、これらの各実施形態は、本発明の最良の実施形態の一例ではあるものの、本発明はこれら実施形態により限定を受けるものではない。

【0083】

〔第一の実施形態〕

本発明を好適に実施した第一の実施形態として、分子中に環状シリカ骨格を有し且つ該環状シリカ骨格に少なくとも一つの不飽和炭化水素基が結合されている環状有機シリカ化合物原料を原料として形成した絶縁膜について説明する。

本実施形態に係る絶縁膜は、分子中に環状シリカ骨格を有し且つ該環状シリカ骨格に少なくとも一つの不飽和炭化水素基が結合されている環状有機シリカ化合物原料の少なくとも一つとして、テトラビニルテトラメチルシクロテトラシロキサン (TVTMCTS) モノマーを原料として用いて形成した。

【0084】

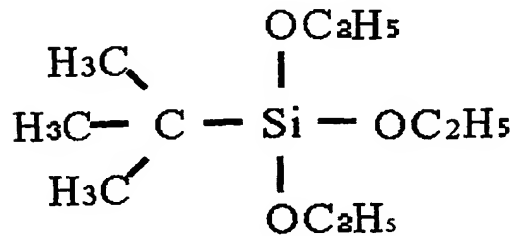
また、比較のために本実施形態に係る絶縁膜とは異なる二種類の材料を用いて絶縁膜を形成した。

このうち一方の絶縁膜 (第 1 の比較用絶縁膜) は、分子中に直鎖状シリカ骨格を有し、

且つ分子中に不飽和炭化水素基を持たない化合物である、下記式 (IX) で示されるターシャリーブチルトリエトキシシランモノマー (TBTES) を材料として用いて形成した。

【0085】

【化14】



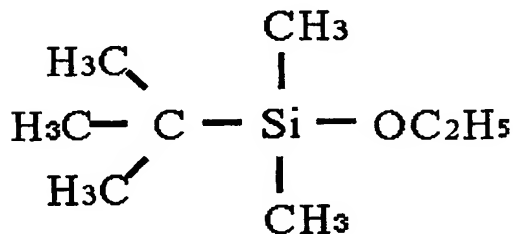
(IX) ターシャリーブチルトリエトキシシラン

【0086】

他方の絶縁膜 (第2の比較用絶縁膜) は、分子中に直鎖状シリカ骨格を有し、且つ分子中に不飽和炭化水素基を持たない化合物である、下記式 (X) で示されるターシャリーブチルジメチルトリエトキシシランモノマー (TBDMES) を材料として用いて形成した。

【0087】

【化15】



(X) ターシャリーブチルジメチルトリエトキシシラン

【0088】

キャリアガスとしては、Heの他にAr、Ne、Xeなど、モノマーに対して不活性なガスを用いることが好適である。キャリアガスの流量は、気化システム内におけるモノマーの分圧がモノマーの飽和蒸気圧よりも小さくなるよう設定すれば良い。キャリアガスとしては、不活性ガスの他にはH₂などが考えられる。しかしながら、H₂をキャリアガスとして用いた場合、H₂はプラズマ中で活性化し、同じくプラズマ中で活性化したモノマーに対して付加反応を生じる。キャリアガスはモノマーに比して気相中に大量に存在するため、膜中の水素含有量の増加を招き、耐熱性の劣化など膜特性の不安定化を誘発する要因となる。従って、キャリアガスとしては、モノマーに対して不活性なHe、Ne、Ar、Xeなどが好適である。

本実施形態に係る絶縁膜及び第1及び第2の比較用絶縁膜は、成膜時にキャリアガスとしてヘリウム8.45×10⁻¹ Pa・m³/sを供給した。

【0089】

上記の各絶縁膜は、図2に示す気化制御器35において原料を気化し、テトラビニルテ

トラメチルシクロテトラシロキサンモノマー 8. $239 \times 10^{-2} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{s}$ 、又は、TVTMCTSモノマーの代わりに、TBTESモノマーを $1.030 \times 10^{-1} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{s}$ 、又はTBDMESモノマーを $1.183 \times 10^{-1} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{s}$ 供給して成膜した。

【0090】

成膜の際には、キャリアガス及び原料の他、希釈ガスとしてヘリウムを $1.690 \times 10^{-1} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{s}$ 流し、反応室1に導入した。350℃に保たれた基板加熱部3に予め200mmφのシリコン基板（半導体基板）2を敷置しておき、さらに反応室1は圧力360Paに減圧し、ほぼ300mmφのシャワーヘッド4に周波数13.56MHz、RF電力50～700Wの高周波を印加し、プラズマ重合反応により、シリコン基板2上に絶縁膜を成長させた。この場合、プラズマ形成パワー密度は、およそ $0.05 \text{ W/cm}^2 \sim 1 \text{ W/cm}^2$ に相当する。なお、ここでは基板加熱部3の温度を350℃としたが、基板加熱部3の温度は、200℃～450℃程度とすることが望ましい。

【0091】

図4に、原料として、TVTMCTSモノマーを $8.239 \times 10^{-2} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{s}$ 供給して形成した絶縁膜（本実施形態に係る絶縁膜）、TBTESモノマーを $1.030 \times 10^{-1} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{s}$ 供給して形成した絶縁膜（第1の比較用絶縁膜）、及びTBDMESモノマーを $1.183 \times 10^{-1} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{s}$ 供給して形成した絶縁膜（第2の比較用絶縁膜）の成膜速度のRF電力依存性（RF電力と成膜速度との関係）を示す。横軸はRF電力（W）、縦軸は成膜速度（nm/min）を表す。分子中に不飽和炭化水素基を有するTVTMCTSを原料として形成した本実施形態に係る絶縁膜は、不飽和炭化水素基を有しないTBTESやTBDMESを原料として形成した第1及び第2の比較用絶縁膜よりも原料流量が少ないにも係わらず、高い成膜速度を示した。

【0092】

プラズマ中に導入された分子蒸気は、プラズマからのエネルギーによって解離・活性化する。この際、シリカ骨格に結合した不飽和炭化水素基は、未結合手を1本以上有するラジカルが生成されやすく、またこれらの未結合手は、分子同士をつなぐ“糊”として作用することで、重合反応が支配的な成膜が進む。

【0093】

一方、不飽和炭化水素基を有しない化合物では、プラズマ中での解離が不飽和炭化水素基を有する化合物に比して選択的に活性化される結合手が少ないため、“糊”となる未結合手が少なく、結果として成膜速度は低くなると推定される。

【0094】

この結果として、分子中に不飽和炭化水素基を有するシリカ化合物は、不飽和炭化水素基を含まないシリカ化合物に比し、成膜速度が高くなる。すなわち、分子中に不飽和炭化水素基を有するTVTMCTSモノマーを原料とした本実施形態に係る絶縁膜は、不飽和炭化水素基を持たないTBTESやTBDMESのモノマーを原料とした第1及び第2の比較用絶縁膜と比し成膜速度が高くなる。また、RF電力を増大することで、ラジカルの形成が促進され、さらに高い成膜速度を得ることが可能である。

【0095】

図5は、原料として、TVTMCTSモノマーを $8.239 \times 10^{-2} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{s}$ 供給して形成した絶縁膜（本実施形態に係る絶縁膜）、TBTESモノマーを $1.030 \times 10^{-1} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{s}$ 供給して形成した絶縁膜（第1の比較用絶縁膜）、及びTBDMESモノマーを $1.183 \times 10^{-1} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{s}$ 供給して形成した絶縁膜（第2の比較用絶縁膜）の比誘電率のRF電力依存性（比誘電率とRF電力との関係）を示す。横軸はRF電力（W）、縦軸は比誘電率を表す。本実施形態に係る絶縁膜並びに第1及び第2の比較用絶縁膜の誘電率を調べたところ、RF電力200W以下においては、いずれの膜も比誘電率は3以下であり、従来利用されてきたSiO₂やフッ素添加SiO₂と比較して低い誘電率を有していた。

【0096】

ただし、分子中に不飽和炭化水素基を持たないシリカ化合物である TBTES、TBDMES モノマーを用いた第 1 及び第 2 の比較用絶縁膜は、RF 電力を 300W 以上まで増加すると、比誘電率は 3 以上まで上昇する。

【0097】

一方、分子中に不飽和炭化水素基を有するシリカ化合物である TVTMCTS を用いて形成した本実施形態に係る絶縁膜は、RF 電力を増加しても、TBTES や TBDMES のモノマーを原料として用いた場合に比べて比誘電率の増分は小さく、RF 電力 500W においても比誘電率を 2.8 以下に維持することができる。

【0098】

TBTES や TBDMES のモノマーを原料として用いた場合、RF 電力の増加によりモノマーの過剰分解と有機成分の脱離とが進行しているために比誘電率の上昇を招いていると推測される。TVTMCTS モノマーを原料として用いた場合は、不飽和炭化水素基に由来するラジカルが主となって成膜が進むため、RF 電力を増加しても、過剰分解したモノマーの取り込みや有機成分の脱離が抑制される。つまり、原料供給律速ではなく、不飽和炭化水素基の活性化律速により成膜速度が決まり、且つ不飽和炭化水素基を介した重合反応によって選択的な成長が進むために、過剰分解したモノマーの取り込みや、有機成分の脱離を生じにくく、結果として比誘電率はほぼ一定の値を取ると推測される。

【0099】

図 6 に、原料として TVTMCTS モノマーを用い、供給量を $2.746 \times 10^{-2} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{s} \sim 1.099 \times 10^{-1} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{s}$ まで変化させて形成した絶縁膜の、RF 電力 200W における成膜速度の原料供給量依存性（原料供給量と成膜速度との関係）を示す。横軸は原料供給量 ($\text{Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{s}$) を、縦軸は成膜速度 (nm / min) を表す。また、図 7 に、原料として TVTMCTS モノマーを用い、供給量を $2.746 \times 10^{-2} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{s} \sim 1.099 \times 10^{-1} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{s}$ まで変化させて形成した絶縁膜の、RF 電力 200W における比誘電率の原料供給量依存性（原料供給量と比誘電率との関係）を示す。横軸は原料供給量 ($\text{Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{s}$) を、縦軸は比誘電率を表す。これらの図に示されるように、TVTMCTS モノマーを原料として用いた本実施形態に係る絶縁膜は、原料の供給量に関わらず成膜速度や比誘電率が一定となる。

【0100】

図 6 に示すように、原料供給量 $2.746 \times 10^{-2} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{s} \sim 1.099 \times 10^{-1} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{s}$ の範囲において、成膜速度はほぼ一定値を取る。このことは、TVTMCTS モノマーを用いた場合の成膜速度が、原料供給律速ではなく、活性化反応律速によって決定することを示唆している。

【0101】

また、図 7 に示すように、原料供給量 $2.746 \times 10^{-2} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{s} \sim 1.099 \times 10^{-1} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{s}$ の範囲において、比誘電率は 2.75 以下を維持している。従って、プラズマによって活性化したモノマーは、環状シリカ骨格を維持したまま、不飽和炭化水素基を介して重合し、その反応は原料供給量に大きく依存しないことが示唆された。なお、 $2.746 \times 10^{-2} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{s}$ 以下では比誘電率がわずかに上昇するが、 $2.746 \times 10^{-2} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{s}$ 以下の領域においては、気相中の原料濃度が低下するため、過剰に分解されるモノマーの取り込みや有機成分の脱離が生じ、これを膜中に取り込むことで比誘電率が上昇すると考えられる。

【0102】

図 8 に、テトラビニルテトラメチルシクロテトラシロキサン (TVTMCTS) モノマーの供給量が $8.239 \times 10^{-2} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{s}$ で、RF 電力が 200W である場合の反応室圧力と成膜速度との関係を示す。横軸は反応室圧力 (Pa) を、縦軸は成膜速度 (nm / min) を表す。ここでは、反応室圧力を 320Pa ~ 440Pa まで変化させた。図示されるように、成膜速度は反応室圧力に対して依存性を示さない。

【0103】

また、図 9 に、テトラビニルテトラメチルシクロテトラシロキサン (TVTMCTS)

モノマーの供給量が $8.239 \times 10^{-2} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{s}$ で、RF 電力が 200 W である場合の反応室圧力と比誘電率との関係を示す。横軸は反応室圧力 (Pa) を、縦軸は比誘電率を表す。ここでは、反応室圧力を 320 Pa ~ 440 Pa まで変化させた。図示されるように、比誘電率は反応室圧力に対して依存性を示さず、ほぼ一定の値を取る。

【0104】

このように、成膜速度が高く、且つ低い比誘電率を安定して得るためには、本実施形態に係る絶縁膜のように、不飽和炭化水素基を有するモノマーを原料として用いるのが好適であることが実証された。

【0105】

すなわち、少なくとも一つの、分子中に環状シリカ骨格を有し且つ該環状シリカ骨格に少なくとも一つの不飽和炭化水素基が結合されている環状有機シリカ化合物原料として、テトラビニルテトラメチルシクロテトラシロキサン (TVTMC TS) モノマーを用いた場合、形成される膜の成膜速度と比誘電率とは、原料流量、RF 電力及び反応室圧力に対して依存性が小さく、すなわちプロセス安定性の極めて高い低誘電率膜を得ることができる。

【0106】

図 10 に、テトラビニルテトラメチルシクロテトラシロキサン (TVTMC TS) モノマーを $1.099 \times 10^{-1} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{s}$ 供給し、RF 電力 200 W において形成した絶縁膜 (本実施形態に係る絶縁膜) について、フーリエ変換赤外分光分析 (FT-IR) によって膜構造を調べた結果を示す。横軸は波数 (cm^{-1}) を、縦軸は吸収量 (a. u) を表す。

原料であるテトラビニルテトラメチルシクロテトラシロキサンモノマーの構造に由来した Si-O 結合 (波数 1040 cm^{-1} 付近)、Si-CH₃ 結合 (波数 800 cm^{-1} 及び 1250 cm^{-1} 付近) 及び C-H 結合 (波数 3000 cm^{-1} 付近)、に起因する振動ピークが観測された。また、この他、Si-H 結合に起因する弱い振動ピーク (波数 1400 cm^{-1} 付近) も観測された。しかしながら、不飽和炭化水素基、すなわち炭素-炭素二重結合 (C=C 結合) に起因するピーク (C=C 結合が存在すると波数 910 cm^{-1} 、 990 cm^{-1} 、 1400 cm^{-1} 及び 1800 cm^{-1} 付近に現れるピーク) は観測されなかった。したがって、形成された絶縁膜は、不飽和炭化水素結合の重合反応により形成されていることが推測できる。

【0107】

また、図 10 に示されるように、形成された膜中には Si-OH に起因するスペクトル (Si-OH 結合が存在すると波数 $3200 \sim 3500 \text{ cm}^{-1}$ 付近に現れる幅広のピーク) が観測されていない。膜中に Si-OH 結合が存在する場合、Si-OH 結合に含まれる -OH 基は、多層配線形成時の熱処理プロセス中に熱の影響を受けたり、ガス成分との反応したりすることにより、Si-OH 基同士での反応や、エッチングガス中に含まれる水素との反応を起こし、この結果 H₂O を生じる。膜中に残留した H₂O を脱離させるには、100℃ 以上での熱処理などが施されるが、これは工程数の増加すなわちコストの増加とスループットの低下を招く。

【0108】

また、H₂O は熱処理によって膜中から脱離するが、同時に膜の収縮を生じる。さらに、膜中に H₂O が水分子の形で残留した場合、H₂O の比誘電率は約 80 であることより、膜の比誘電率の大幅な上昇を招く。従って、本発明のように、形成された膜中に Si-OH 結合が含まれないことが望ましい。

【0109】

図 11 に、原料としてテトラビニルテトラメチルシクロテトラシロキサン (TVTMC TS) モノマーを $2.746 \times 10^{-2} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{s}$ 又は $1.099 \times 10^{-1} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{s}$ 供給し、RF 電力 200 W において形成した絶縁膜について、小角 X 線散乱法によって膜中の空孔 (ポア) 分析を行った結果を示す。横軸は空孔径 (nm) を、縦軸は空孔分布 (nm^{-1}) を表す。いずれにおいても、膜中からは空孔が検出され、形成された膜が多

孔質絶縁膜であることが確認された。また、絶縁膜中の空孔の最大分布径は、原料供給量が $2.746 \times 10^{-2} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{s}$ の場合において 0.30 nm 、原料供給量が $1.099 \times 10^{-1} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{s}$ の場合において 0.48 nm であった。

【0110】

本実施形態により得られた多孔質絶縁膜と、空孔径が 3 nm 以上である他の多孔質絶縁膜と、Thermal Desorption Spectroscopy (TDS) 測定を行ったところ、 3 nm 以上の空孔を有する多孔質絶縁膜では、 H_2O の脱離ガススペクトル強度は本実施形態に記載の多孔質絶縁膜に比して5倍以上に増大することが明らかとなった。このことは、空孔径が 3 nm 以上に大きくなると、膜の吸湿が促進されることを示唆している。従って、空孔径を 3 nm 以下、望ましくは 2 nm 以下とすることで吸湿性を改善できる。また、空孔径が 3 nm 以下と小さくすることで、吸湿性の改善のみならず、プロセスガスの吸蔵、薬液の浸析などを抑制できるという利点を有する。

【0111】

表1に、原料としてテトラビニルテトラメチルシクロテトラシロキサン (TVTMC TS) モノマーを $1.099 \times 10^{-1} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{s}$ 供給し、形成した本実施形態に係る絶縁膜について、ラザフォード後方散乱/水素前方散乱 (RBS/HFS) 法により、膜中元素の組成分析を行った結果を示す。膜中からは、原料であるテトラビニルテトラメチルシクロテトラシロキサンモノマーに由来する Si、O、C、H が検出された。

【0112】

【表1】

元素	Siを1としたときの存在比
O	0.95
C	2.18
H	5.52

【0113】

モノマーの組成は、 $\text{O}/\text{Si}=1$ 、 $\text{C}/\text{Si}=3$ 、 $\text{H}/\text{Si}=6$ である。従って、形成された膜は、モノマーから炭素原子、水素原子がそれぞれ一つずつ少ない組成となっている。図8に示したFT-IR測定結果より、Si-H結合に起因する振動ピークが見られることから、一部のSi-CH₃結合がSi-H結合に置換されたり、またビニル結合の一部の炭化水素が脱離するなどし、結果として炭素原子、水素原子が少なくなっているものと推測される。一方、形成された膜には、シリコン原子と酸素原子がほぼ1:1で含有されており、環状シリカ骨格は破壊されずに膜中に存在していることを示している。

【0114】

図12に、テトラビニルテトラメチルシクロテトラシロキサンモノマーの供給量を $2.746 \times 10^{-2} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{s} \sim 1.099 \times 10^{-1} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{s}$ まで変化させ、RF電力200Wにおいて形成した本実施形態に係る絶縁膜について、電流電圧特性（電界強度とリーク電流密度との関係）を測定した結果である。横軸は電界強度 (MV/cm) を、縦軸はリーク電流密度 (A/cm^2) を示す。リーク電流は電界強度 $1 \text{ MV}/\text{cm}$ において $1 \times 10^{-9} \text{ A}/\text{cm}^2$ 以下、絶縁耐圧は $5 \text{ MV}/\text{cm}$ 以上を示し、MOSFETデバイスが多層配線を形成する際の層間絶縁膜として、十分実用的な特性を有していた。

【0115】

以上の結果より、分子中に環状シリカ骨格を有し且つ該環状シリカ骨格に少なくとも一つの不飽和炭化水素基が結合されている環状有機シリカ化合物原料を原料として形成された本実施形態に係る絶縁膜は、膜中に空孔を含有する構造であり、かつ低誘電率な多孔質SiOCH絶縁膜であることが確認された。

【0116】

〔第二の実施形態〕

本発明を好適に実施した第二の実施形態として、原料としてテトラビニルテトラメチルシクロテトラシロキサンモノマーを用い、酸化剤ガスとして亜酸化二窒素 (N_2O) を用いた場合について絶縁膜について説明する。

本実施形態においては、キャリアガスとして、ヘリウム $8.450 \times 10^{-1} \text{Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{s}$ を供給した。また、原料であるテトラビニルテトラメチルシクロテトラシロキサンモノマーは、図2に示す気化制御器35において気化し、 $1.099 \times 10^{-1} \text{Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{s}$ を供給した。希釈ガスとしてヘリウムを $1.690 \times 10^{-1} \text{Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{s}$ 流し、反応室1に導入した。さらに $5.408 \times 10^{-2} \text{Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{s} \sim 2.197 \times 10^{-1} \text{Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{s}$ の N_2O を反応室1に導入した。

【0117】

反応室1内には、 350°C に保たれた基板加熱部3にあらかじめ半導体基板2を敷置しておき、さらに反応室1は圧力 360Pa に減圧し、シャワーヘッド4に周波数 13.56MHz 、RF電力 200W の高周波を印加してプラズマを発生させ、半導体基板2上に絶縁膜を成長させた。 N_2O を加えたことを除いては、第一の実施形態と同様の方法で成膜を行った。

【0118】

図13に、成膜速度と N_2O 添加量との関係を示す。横軸は N_2O の供給量 ($\text{Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{s}$) を、縦軸は成膜速度 (nm/min) を表す。図示されるように、 N_2O の添加量に比例して、成膜速度が増加する。これはスループットと、原料コストとを改善する上で重要な効果である。換言すると、成膜時に N_2O を添加することによってスループットと原料利用効率とを改善できる。

【0119】

図14に、成膜速度と希釈ヘリウムガスの流量との関係を示す。横軸は希釈ヘリウムガスの流量 ($\text{Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{s}$) を、縦軸は成膜速度 (nm/min) を表す。図からも明らかなように、希釈ヘリウムガスを増量しても、成膜速度はほぼ一定値を示す。

【0120】

N_2O を用いることで成膜速度が向上する正確な促進反応機構は現時点でわかっていないが、不飽和炭化水素基中の炭素の一部が酸素と結合して CO 又は CO_2 として引き抜かれ、後に残った炭素ラジカルを介して環状有機シリカ化合物が重合してゆくものと推測される。ヘリウムを増量した場合は、このような“引き抜き”反応は生じないため、結果として成膜速度はほとんど変わらない。

【0121】

ここで肝要なことは、該環状シリカ骨格を破壊させることなく、かつこれに結合する不飽和炭化水素基を優先的に活性化させるプラズマが必要不可欠なことである。不飽和炭化水素の活性化は、プラズマのエネルギーを高くすること、すなわちRF電力を大きくすることが有効であるが、不飽和炭化水素基を優先的に活性化させるには、十分な成膜速度を得られる範囲において、RF電力をできるだけ小さくすることが効果的である。より具体的には、RF電力を $100 \text{W} \sim 500 \text{W}$ 程度の範囲に設定することが望ましい。このことは、下地面に与えるプラズマダメージを小さくするという副次的効果をももたらす。

【0122】

今回の検討範囲は、 $\text{N}_2\text{O} = 2.197 \times 10^{-1} \text{Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{s}$ までであるが、 $2.197 \times 10^{-1} \text{Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{s}$ を超える N_2O の添加により、さらに成膜速度を向上できることは明らかである。すなわち、本実施形態に係る絶縁膜は、分子中に環状シリカ骨格を有し且つ該環状シリカ骨格に少なくとも一つの不飽和炭化水素基が結合されている環状有機シリカ化合物原料の蒸気と酸化ガスとからなる混合ガスをプラズマ中に導入することに特徴があり、その混合比を限定するものではない。

【0123】

図15に、 N_2O を $5.408 \times 10^{-2} \text{Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{s}$ 、 $1.099 \times 10^{-1} \text{Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{s}$ 、又は $2.197 \times 10^{-1} \text{Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{s}$ 添加して形成した絶縁膜について、フーリエ変換赤外分光分析 (FT-IR) によって膜構造を調べた結果を示す。横軸は波数 (

cm^{-1}) を、縦軸は吸収量 (a. u) を表す。原料であるテトラビニルテトラメチルシクロテトラシロキサンモノマーの構造に由来した Si-O 結合 (波数 1040 cm^{-1} 付近)、Si-CH₃ 結合 (波数 800 cm^{-1} 及び 1250 cm^{-1} 付近)、C-H 結合 (波数 3000 cm^{-1} 付近) に起因する振動ピークが観測された。また、この他、Si-H 結合に起因する弱い振動ピーク (波数 1400 cm^{-1} 付近) も観測された。しかしながら、不飽和炭化水素基、すなわち炭素-炭素二重結合 (C=C 結合) に起因するピーク (C=C 結合が存在すると波数 910 cm^{-1} 、 990 cm^{-1} 、 1400 cm^{-1} 及び 1800 cm^{-1} 付近に現れるピーク) は観測されなかった。

【0124】

また、図 15 から明らかなように、本実施形態に係る絶縁膜は、N₂O の添加量のよらず、ほぼ同一のスペクトルを示した。さらに、このスペクトルは図 10 に示した第一の実施形態に係る絶縁膜のスペクトルとほぼ一致するため、本実施形態にかかる絶縁膜が、図 10 に示す N₂O を添加しない膜 (すなわち、第一の実施形態に係る絶縁膜) とほぼ同様の膜構造を有していることを確認できる。したがって、本実施形態に係る絶縁膜は、第一の実施形態に係る絶縁膜と同様に、不飽和炭化水素結合の重合反応により形成されていると推測できる。

【0125】

また、形成された膜中には Si-OH に起因するスペクトル (Si-OH 結合が存在すると波数 $3200\sim3500\text{ cm}^{-1}$ 付近に現れる幅広のピーク) が観測されていない。膜中に Si-OH 結合が存在する場合、Si-OH 結合に含まれる -OH 基は、多層配線形成時の熱処理プロセス中に熱の影響を受けたり、ガス成分との反応したりすることにより、Si-OH 基同士での反応や、エッチングガスに含まれる水素との反応を起こし、この結果 H₂O を生じる。膜中に残留した H₂O を脱離させるには、 100°C 以上での熱処理などが用いられるが、これは工程数の増加すなわちコストの増加とスループットの低下を招く。

【0126】

また、H₂O は熱処理によって膜中から脱離するが、同時に膜の収縮を生じる。さらに、膜中に H₂O が水分子の形で残留した場合、H₂O の比誘電率は約 80 であることより、膜の比誘電率の大幅な上昇を招く。従って、形成された膜中に Si-OH 結合が含まれないことが望ましい。

【0127】

図 16 に、N₂O を $1.099 \times 10^{-1}\text{ Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$ 添加して形成した本実施形態にかかる絶縁膜について、小角 X 線散乱法により、膜中の空孔 (ポア) 分析を行った結果を示す。横軸は空孔径 (nm) を、縦軸は空孔分布 (nm^{-1}) を表す。膜中からは最大分布 0.40 nm の空孔が検出され、本実施形態に係る絶縁膜が空孔を含有する多孔質絶縁膜であることが確認された。

【0128】

表 2 は、N₂O を $1.099 \times 10^{-1}\text{ Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$ 添加して形成した絶縁膜について、ラザフォード後方散乱/水素前方散乱 (RBS/HFS) 法により、膜中元素の組成分析を行った結果である。膜中からは、原料であるテトラビニルテトラメチルシクロテトラシロキサンモノマーに由来する Si、O、C、H が検出された。また、N₂O を用いていない、第一の実施形態に示した膜とほぼ同一の組成比を有していた。

【0129】

【表2】

元素	Siを1としたときの存在比
O	1. 15
C	2. 35
H	5. 16

【0130】

上記の分析結果は、 $N_2 O$ を添加した場合においても、第一の実施形態に示した絶縁膜と同様に、不飽和炭化水素基を介した反応によって膜が形成されていることを示唆している。添加ガスとして $N_2 O$ を導入すると、プラズマ中で不飽和炭化水素基中の炭素の一部が酸素と結合してCOあるいは CO_2 として引き抜かれ、後に残った炭素ラジカルを介して環状有機シリカ化合物が重合してゆくものと推測される。

【0131】

従って、モノマーの組成比 $O/Si=1$ 、 $C/Si=3$ 、 $H/Si=6$ に比して、形成された膜は、モノマーから炭素原子、水素原子がそれぞれ一つずつ少ない組成となっている。またこのほかにも、図15に示したFT-IR測定結果において、 $Si-H$ 結合に起因する振動ピークが見られることから、一部の $Si-CH_3$ 結合が $Si-H$ 結合に置換されているものと考えられ、結果として炭素原子や水素原子がモノマー組成に比して少なくなっているものと推測される。しかしながら、本実施形態に係る絶縁膜は、シリコン原子と酸素原子がほぼ1:1で含有されており、 $N_2 O$ を用いない第一の実施形態と同様に、環状シリカ骨格は破壊されずに膜中に存在していることを示唆している。

【0132】

図17に、テトラビニルテトラメチルシクロテトラシロキサンモノマーの供給量を $1.099 \times 10^{-1} Pa \cdot m^3 / s$ とし、 $N_2 O$ 添加量を $5.408 \times 10^{-2} Pa \cdot m^3 / s$ 、 $1.099 \times 10^{-1} Pa \cdot m^3 / s$ 、 $2.197 \times 10^{-1} Pa \cdot m^3 / s$ とし、RF電力200Wにおいて形成した絶縁膜について、比誘電率を測定した結果を示す。横軸は $N_2 O$ の添加量($Pa \cdot m^3 / s$)を、縦軸は比誘電率を表す。形成した膜の誘電率を調べたところ、 $N_2 O$ の添加量によらず、約2.6~2.7であり、従来利用されてきた SiO_2 やフッ素添加 SiO_2 よりも低い誘電率を有していた。

【0133】

従って、RF電力200W程度では、成膜時に $N_2 O$ を添加しても環状シリカ骨格を破壊させることなく、かつこれに結合する不飽和炭化水素基を優先的に活性化させ、 $N_2 O$ を添加しない場合と同様に、不飽和炭化水素基に由来するラジカルが主となって成膜が進むと推測できる。このため、 $N_2 O$ 添加量を増加することで、活性化したモノマーが増加し、不飽和炭化水素基を介した付加反応又は置換反応によって選択的な成長が進むために、形成される膜は環状シリカ骨格を基本骨格として成長し、過剰分解したモノマーの取り込みや、有機成分の脱離を生じにくく、結果として比誘電率はほぼ一定の値を取ると推測される。

【0134】

図18に、テトラビニルテトラメチルシクロテトラシロキサンモノマーの供給量を $1.099 \times 10^{-1} Pa \cdot m^3 / s$ とし、 $N_2 O$ 添加量を $5.408 \times 10^{-2} Pa \cdot m^3 / s$ 、 $1.099 \times 10^{-1} Pa \cdot m^3 / s$ 、 $2.197 \times 10^{-1} Pa \cdot m^3 / s$ とし、RF電力200Wにおいて形成した絶縁膜について、電流電圧特性を測定した結果を示す。横軸は電界強度(MV/cm)を、縦軸はリーク電流密度(A/cm^2)を表す。リーク電流は電界強度1MV/cmにおいて $1 \times 10^{-9} A/cm^2$ 以下、絶縁耐圧は5MV/cm以上を示し、MOSFETデバイスの多層配線を形成する際の層間絶縁膜として、十分実用的な特性を有していた。

【0135】

以上の結果より、本実施形態に係る絶縁膜は、膜中に空孔を含有する構造であり、かつ低誘電率な多孔質SiOCH絶縁膜であることが確認された。

【0136】

〔第三の実施形態〕

本発明を好適に実施した第三の実施形態について説明する。本実施形態に係る絶縁膜は、分子中に環状シリカ骨格を有し、且つ該環状シリカ骨格に少なくとも一つの不飽和炭化水素基が結合されている環状有機シリカ化合物としてテトラビニルテトラメチルシクロテトラシロキサンモノマー、分子中に直鎖状シリカ骨格を有し、且つ該直鎖状シリカ骨格の側鎖に水素、炭化水素基及び酸化炭化水素基からなる群から選択されるいずれかが結合された直鎖状有機シリカ化合物として、上記式(IV)で表されるジビニルシロキサンベンゾシクロブテンモノマーを用い、両モノマーの分子蒸気を混合し、また酸化剤ガスとして亜酸化二窒素(N_2O)を添加して成膜を行った絶縁膜である。

なお、本実施形態においては、水素炭化水素基及び酸化炭化水素基から選択されるいずれかが側鎖に結合されている直鎖状シリカ化合物として、側鎖中に不飽和炭化水素結合を有するジビニルシロキサンベンゾシクロブテンモノマーを用いているが、側鎖中に不飽和炭化水素結合を含まない直鎖状有機シリカ化合物を用いても良い。ただし、環状有機シリカ化合物と同様に少なくとも一つは不飽和炭化水素結合を有することが、成膜速度の向上即ちスループットの向上の観点からは好ましい。

【0137】

キャリアガスとして、テトラビニルテトラメチルシクロテトラシロキサンモノマーに対してヘリウム $5.070 \times 10^{-1} Pa \cdot m^3 / s$ 、ジビニルシロキサンベンゾシクロブテンモノマーに対してヘリウム $8.450 \times 10^{-1} Pa \cdot m^3 / s$ を供給した。

【0138】

テトラビニルテトラメチルシクロテトラシロキサンモノマーを図1に示す気化制御器16aにおいて気化し、 $0 \sim 1.099 \times 10^{-1} Pa \cdot m^3 / s$ を供給した。また、ジビニルシロキサンベンゾシクロブテンモノマーを図1に示す気化制御器16bにおいて気化し、 $7.605 \times 10^{-3} Pa \cdot m^3 / s$ を供給した。さらに、これらの原料とともに $0 \sim 6.760 \times 10^{-2} Pa \cdot m^3 / s$ の N_2O を供給した。これらを図1に示す配管15にて混合したのち、反応室1に導入した。反応室1の内部には、 $350^\circ C$ に保たれた基板加熱部にあらかじめ基板を敷置しておき、圧力 $360 Pa$ に減圧し、シャワーヘッドに周波数 $13.56 MHz$ 、RF電力 $200 W$ の高周波を印加してプラズマを発生させ、基板上に絶縁膜を成長させた。

【0139】

図19に、テトラビニルテトラメチルシクロテトラシロキサン(TVTMCTS)モノマーと、ジビニルシロキサンベンゾシクロブテン(BCB)モノマーと、を用いて成膜を行った際の、成膜速度のモノマー供給比依存性(モノマー供給比と成膜速度との関係)を示す。横軸は供給したモノマーの総量に対するTVTMCCTSの割合を、縦軸は成膜速度(nm/min)を表す。TVTMCCTSモノマー及びBCBモノマーの混合気を用いて成膜することによって、テトラビニルテトラメチルシクロテトラシロキサンモノマーのみ($(TVTMCCTS / (TVTMCCTS + BCB)) = 1$)、ジビニルシロキサンベンゾシクロブテンモノマーのみ($(TVTMCCTS / (TVTMCCTS + BCB)) = 0$)を用いた場合に比して、成膜速度が向上した。酸化剤ガスとして、 N_2O を添加することで、成膜速度はさらに向上する。

【0140】

また、両モノマーの供給比が1:1となる付近で、成膜速度は極大値をもつことを見出した。

TVTMCCTSモノマーとBCBモノマーを同時に供給した場合、TVTMCCTSモノマーリッチな領域においては、成膜速度はTVTMCCTSモノマーの活性化が支配的となり、従って成膜速度はTVTMCCTSモノマーを単独で用いた場合に近づく。一方でBCBモノマーリッチな領域では、BCBモノマーの活性化が支配的となり、BCBモノマー

を単独で用いた場合の成膜速度に近づく。

【0141】

しかしながら、TVTMCTSモノマーとBCBモノマーの供給比を1:1とすると、両モノマーに具有される不飽和炭化水素基に由来する重合反応が最も促進され、これにより成膜速度は極大値をとると推測される。

【0142】

図19では、 $N_2O = 6.760 \times 10^{-2} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{s}$ までの結果を示しているが、 N_2O をさらに増量することで、成膜速度が向上するのは明らかである。これらの効果は、デバイスのスループット改善と原料コストの低減に有効である。

【0143】

図20に、モノマー供給比と比誘電率との関係を示す。横軸は供給したモノマーの総量に対するTVTMCTSの割合を、縦軸は比誘電率を表す。 N_2O を用いない場合、比誘電率は供給比1:1付近で極大値をとることを見出した。

【0144】

ジビニルシロキサンベンゾシクロブテン(BCB)モノマーは、Si-O骨格に嵩の大きな有機側鎖を有した構造となっている。従って、BCBモノマーとヘリウム(キャリアガス)のみを用いて膜を形成した場合、膜中に嵩の大きな有機基が取り込まれ、結果として極性原子であるシリコンや酸素の存在比が小さくなるため、低い比誘電率を得ることができる。

【0145】

テトラビニルテトラメチルシクロテトラシロキサン(TVTMCTS)モノマー及びヘリウム(キャリアガス)のみを用いて膜を形成した場合((TVTMCTS/(TVTMCTS+BCB))=1)は、Si-O骨格が形成する分子空孔を効果的に膜中に取り込むことにより、BCB膜((TVTMCTS/(TVTMCTS+BCB))=0)に比して少ない有機含有量にも係わらず、低い誘電率を得ることができる。TVTMCTSモノマーとBCBモノマーとの両方を供給した場合、TVTMCTSモノマーによって形成された空孔に、BCBモノマーに由来するSi-O、有機基が、いわば“入り込む”ことにより、それぞれのモノマーを単独で用いた膜に比して、より緻密な膜となってしまうと推測される。比誘電率は膜密度と相関があり、膜密度が大きいほど比誘電率は高くなる。従って、TVTMCTSモノマーとBCBモノマーとを等量供給した場合、両モノマーに具有される不飽和炭化水素基に由来する重合反応が最も促進され、すなわち最も緻密な膜が形成され、結果として比誘電率は極大値を取ると推測される。

【0146】

一方、テトラビニルテトラメチルシクロテトラシロキサン(TVTMCTS)モノマーとジビニルシロキサンベンゾシクロブテンモノマーとに加えて N_2O を $3.380 \times 10^{-2} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{s}$ 添加した場合、比誘電率は極小値をとり、TVTMCTSモノマー流量 $2.746 \times 10^{-2} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{s}$ において(TVTMCTS/(TVTMCTS+BCB)=0.783)最も低い比誘電率2.55と、TVTMCTSモノマーを単独で用いた絶縁膜よりも低い比誘電率を得た。

【0147】

TVTMCTSモノマーのみを用いて成膜を行った場合、第二の実施形態に示したように、環状シロカ骨格を破壊しない程度のRF電力であれば、 N_2O を添加しても、しなくても、不飽和炭化水素基を介した付加反応あるいは置換反応によって膜が形成され、その比誘電率は N_2O の添加量によらず約2.6~2.7とほぼ一定である。

【0148】

一方で、BCBモノマーのみを用いて成膜を行った場合、 N_2O を添加しない場合の比誘電率は2.7程度であるが、 N_2O を添加することで、比誘電率は約2.9まで上昇する。これは N_2O が酸化剤として作用し、モノマーの酸化、有機基の脱離が促進され、結果としてよりSi-O結合の多い膜が形成されているためと考えられる。すなわち、BCBモノマーと N_2O とがプラズマ中に同時に存在する場合、BCBモノマーから脱離した

有機基が多く存在している。TVTMCTSモノマー及びBCBモノマーと、 N_2O とを同時に反応室内に導入し、適切なRF電力を印加すると、TVTMCTSモノマーは環状シリカ骨格を維持したまま活性化する一方、BCBモノマーは過剰に分解され、嵩の大きな有機基が脱離する。この時、BCBモノマーから脱離した嵩の大きな有機基は、TVTMCTSの環状シリカ骨格に結合したり、あるいはTVTMCTS同士の結合の際に空間的な“隙間”を形成することで、あたかも“空孔形成剤”として作用することで、膜中に三次元的な空孔を形成し、 N_2O を添加しない場合に比して低い比誘電率を得ることができると推測される。

【0149】

N_2O の流量が多い場合、BCBモノマーの解離はさらに進み、この場合は膜密度の増加を招くため、比誘電率を小さくするためには、TVTVCTSモノマー流量と、BCBモノマー流量と、 N_2O 流量との間に最適比が存在すると考えられる。

【0150】

図21に、テトラビニルテトラメチルシクロテトラシロキサンモノマー (TVTMCTS) と、ジビニルシロキサンベンゾシクロブテンモノマー (BCB) とを用いて成膜した絶縁膜をラザフォード後方散乱/水素前方散乱 (RBS/HFS) 法によって組成分析した結果を示す。横軸はモノマー供給比を、縦軸は元素の相対濃度を表す。

【0151】

供給比を変化させることで、膜中の水素及び炭素の濃度を任意に変化させることが可能である。具体的には、成膜時にテトラビニルテトラメチルシクロテトラシロキサンモノマー、ビニルシロキサンベンゾシクロブテンモノマー及び N_2O の供給量を変化させることで、成膜厚方向に炭素、水素濃度が段階的または連続的に異なり、且つ膜全体の実効的な比誘電率を低減させた膜を容易に作製することができる。

【0152】

例えば、図22に示すように、成膜初期においてはテトラビニルテトラメチルシクロテトラシロキサン (TVTMCTS) モノマー $1.099 \times 10^{-1} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{s}$ 及び $N_2O = 1.099 \times 10^{-1} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{s}$ を供給し、その後、TVTMCTSモノマー流量を $2.746 \times 10^{-2} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{s}$ にし、同時にジビニルシロキサンベンゾシクロブテンモノマー $7.605 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{s}$ 及び $N_2O = 3.38 \times 10^{-2} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{s}$ を供給する。その後成膜終期に再びTVTMCTSモノマー $1.099 \times 10^{-1} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{s}$ と $N_2O = 1.099 \times 10^{-1} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{s}$ とを供給する。この時、シャワーヘッド4には、13.56MHz、200WのRF電力を印加する。

【0153】

これら一連のプロセスを連続で行うことで、膜の上下面の炭素・水素濃度が膜内部に比して低く、かつ高い成膜速度を有する膜を一括に形成することができる。この時、膜全体の実効的な比誘電率は、TVTMCTSモノマーと N_2O を用いた膜よりも小さくなる。また、同様にして、成膜初期においてテトラビニルテトラメチルシクロテトラシロキサン (TVTMCTS) モノマー、ジビニルシロキサンベンゾシクロブテン (BCB) モノマー及び N_2O を供給し、その後BCBモノマーの供給をストップし、成膜終期において再度BCBモノマーを供給することで、膜の上下界面の炭素、水素濃度を、膜内部に比して高くすることが容易である。

【0154】

さらに、テトラビニルテトラメチルシクロテトラシロキサンモノマー、ジビニルシロキサンベンゾシクロブテンモノマー及び N_2O は、それぞれパルス状あるいはランプ状に供給することで膜中の炭素濃度及び水素濃度を段階的又は連続的に制御可能である。

【0155】

本実施形態にかかる絶縁膜は、隣接する半導体材料との密着性を向上させることにも有効である。

層間絶縁膜の低誘電率化を図るためには、膜中に含有される極性元素（酸素やシリコンなど）の比率を小さくすること、すなわち、膜中の有機基の比率を大きくすることが有効

である。しかしながら、酸素やシリコンといった極性元素の比率を低減すると、他の半導体材料との界面に存在する極性元素の面密度が減少することや、接触界面において組成が急激に変化することにより、結果として高い密着性を維持することが困難となる。

【0156】

本実施形態に係る絶縁膜は、原料として、分子中に環状シリカ骨格を有し且つ該環状シリカ骨格に少なくとも一つの不飽和炭化水素基が結合されている有機シリカ化合物と、分子中に直鎖状シリカ骨格を有し且つ該直鎖状シリカ骨格の側鎖に水素、炭化水素基及び酸化炭化水素基からなる群から選択されるいずれかが結合されている直鎖状有機シリカ化合物とを用いて、例えばそれぞれの有機シリカ化合物の供給比を適宜制御することで、同一反応室内において連続的に異なる絶縁膜を成膜することが可能である。さらに該絶縁膜中の炭素濃度を任意に制御する事が可能であることから、該絶縁膜が他の半導体材料と接する上下界面付近または一方の界面付近の膜組成を、段階的または連続的に変化させ、接する半導体材料との密着性を向上させるように制御することが容易となる。

【0157】

〔第四の実施形態〕

第四の実施形態として、上記第一～第三の実施形態に係る絶縁膜を用いて多層配線を作成したMOSFETデバイスについて説明する。図23は、MOSFETデバイスにおける多層配線構造の一例を模式的に示した断面図である。

【0158】

上記構造の多層配線構造を形成する手順について説明する。まず、シリコン基板70にMOSFETデバイスを形成する。これは、従来と同様に、例えば、シリコン基板70の酸化、窒化膜の形成、フォトレジスト(PR)膜の形成、PR膜の露光、現像、エッチング、PR膜の剥離、フィールド酸化膜(素子分離領域)形成、エッチング、ゲート酸化膜形成、ゲート電極形成、ソース及びドレイン領域の形成という各工程を経て行われる。

【0159】

次に、上記手順で形成したMOSFETデバイスの上に無機層間絶縁膜73を形成する。その後、無機層間絶縁膜73の一部を部分的に除去し、ドレイン領域及びソース領域のそれぞれに通ずる孔を形成する。その後、無機層間絶縁膜73の全面に導電性材料(タンゲステンや銅など)層を形成し、不要部分を除去することで、無機層間絶縁膜73に形成した孔をコンタクトプラグ(ビア)72とする。

【0160】

次に、ビア72が形成されたMOSFET上に銅拡散バリア層74と第一層目多孔質絶縁膜75a及び第一層目ハードマスク75bからなる第一層目層間絶縁膜75とを形成する。

【0161】

次に、第一層目層間絶縁膜75上に、PR膜を形成する。配線パターンに合わせてPR膜を露光し、これを現像することによって、配線溝を形成しようとする部分のみPR膜を除去する。その後、PR膜をマスクとしてドライエッチングを行って第一層目層間絶縁膜75及び銅拡散バリア層74を部分的に除去し、マスクされていない部分に配線溝を形成する。配線溝を形成し終わったら、PR膜を除去する。

【0162】

次に、形成した配線溝の内部を含むMOSFETデバイスの全面に、銅拡散バリア金属76及び銅膜を形成し、これらの余剰分をCMPによって除去することで第一層目銅配線77が完成する。

【0163】

第一層目銅配線77を形成したら、その上に第一ビア層間絶縁膜79aを形成し、さらに第二配線層間絶縁膜79bを積層することによって第二層目層間絶縁膜79を形成する。そして、第二層目層間絶縁膜79の上に銅拡散バリア層78を形成する。

【0164】

銅拡散バリア層78を形成したら、この上にPR膜を形成する。配線パターン及びビア

パターンに合わせてPR膜を露光しこれを現像することによって、のちに第二層目配線80又は第一ビア85が形成される部分のみPR膜を除去する。その後、PR膜をマスクとしてドライエッチングを行って第一ビア層間絶縁膜79a及び第二配線層間絶縁膜79bを部分的に除去し、マスクされていない部分に配線溝及びビアホールを形成する。

【0165】

次に、形成したビアホール及び配線溝の内部を含むMOSFETデバイスの全面に、銅拡散バリア金属83及び銅膜を形成し、これらの余剰分をCMPによって除去することで第二層目銅配線80及び第一ビア85を形成する。

【0166】

第一ビア85を形成したら、その上に第二ビア層間絶縁膜81aを形成し、さらに第三配線層間絶縁膜81bを積層することによって第三層目層間絶縁膜81を形成する。そして、第三層目層間絶縁膜81の上に銅拡散バリア層78を形成する。

【0167】

銅拡散バリア層78を形成したら、この上にPR膜を形成する。配線パターン及びビアパターンに合わせてPR膜を露光しこれを現像することによって、のちに第三層目配線82又は第二ビア86が形成される部分のみPR膜を除去する。その後、PR膜をマスクとしてドライエッチングを行って第二ビア層間絶縁膜81a及び第二配線層間絶縁膜81bを部分的に除去し、マスクされていない部分に配線溝及びビアホールを形成する。

【0168】

次に、形成したビアホール及び配線溝の内部を含むMOSFETデバイスの全面に、銅拡散バリア金属84及び銅膜を形成し、これらの余剰分をCMPによって除去することで第三層目銅配線82及び第二ビア86を形成する。このような手順によって、図23に示すような多層配線構造が形成される。

【0169】

なお、さらに多層化した構成とする場合には、層間絶縁膜及び銅拡散バリア層の形成、配線溝及びビアホールの形成、並びに配線及びビアの形成といった工程を繰り返し実行すればよい。

【0170】

図23に示す構成では、第三の実施形態にかかる絶縁膜を配線層に、第二の実施形態にかかる絶縁膜をビア層に適用し、デュアルダマシン配線構造を形成した。

デュアルダマシン配線構造を形成する際には、配線層及びビア層に適用する絶縁膜材料のエッチング選択比が高いこと（換言すると、配線層とビア層とでエッチング速度の差が大きいこと）が好ましい。上記説明した多層構造絶縁膜の作製方法では、膜中の炭素、水素濃度を容易に制御可能であるため、エッチング選択比を容易に高めることができる。

【0171】

例えば、膜中のSi-O結合は一般的にCF_xガスによってドライエッチング可能である。また、有機成分については、N₂とH₂との混合気、又はO₂などによりドライエッチング可能である。SiOCH膜中の炭素、水素濃度が異なる場合、たとえばエッチングガスをN₂とH₂とCF_xやO₂とArとCF_xの混合気を用いて、それぞれのガスの供給比、CF_xガス種を変化させることで、エッチング選択比を制御することが可能である。

【0172】

従って、テトラビニルテトラメチルシクロテトラシロキサン(TVTMCTS)モノマー又はTVTMCSTモノマーとN₂Oとを用いた絶縁膜(第一、第二の実施形態にかかる絶縁膜)と、TVTMCSTモノマーとジビニルシロキサンベンゾシクロブテン(BCB)モノマー又はTVTMCSTモノマーとBCBモノマーとN₂Oとを用いた炭素濃度の高い絶縁膜(第三の実施形態にかかる絶縁膜)とを積層することで、高いエッチング選択比を得ることができる。

【0173】

また、上記第三の実施形態において説明したように、環状シリカ構造を持つ原料と、直

鎖状シリカ構造を持つ原料との供給比を成膜途中で変更することで、組成の異なる絶縁膜を連続して形成することが可能である。よって、図 23 に示した多層配線構造においても、同一反応室内で、配線層とビア層とを連続的に成膜可能であるため、炭素濃度の異なる絶縁膜を連続に成膜することで、エッチング選択比とスループットとを同時に改善できる。

なお、本実施形態では、ビア層には第二の実施形態にかかる絶縁膜を、配線層としてはビア層に比して炭素濃度の高い第三の実施形態にかかる絶縁膜を用いているが、配線層に第二の実施形態にかかる絶縁膜を用い、ビア層に配線層の絶縁膜に比して炭素濃度の高い第三の実施形態にかかる絶縁膜を用いても、同様の効果が得られることは明らかである。

また、本実施形態では、配線層とビア層とに上記各実施形態において説明した多孔質絶縁膜を用いているが、配線層及びビア層いずれかのみ、上記いずれかの実施形態にかかる多孔質絶縁膜を用いても、実効的な比誘電率を低減するのに有効である。

【0174】

〔第五の実施形態〕

第五の実施形態として、多層配線構造のビア層と配線層との間のエッチングストップパ層として上記第一～第三の実施形態にかかる絶縁膜を適用した MOSFET デバイスについて説明する。

【0175】

図 24 は、MOSFET デバイスにおける多層配線構造の一例を模式的に示した断面図である。この図に示す構成では、炭素濃度の異なる二種類の絶縁膜を用いる。配線層及びビア層としてそれぞれ用いたいずれの絶縁膜と比しても炭素濃度の高い絶縁膜を、エッチングストップパ層として配線層とビア層との間に設けた上で、デュアルダマシン配線構造を形成した。

【0176】

図 24 に示す多層配線積層構造を形成する手順は、上記第四の実施形態において説明した手順とはほぼ同様である。ただし、ビア層間絶縁膜 79a や 81a を形成したら、エッチングストップパ層 79c, 81c を形成してから配線層間絶縁膜 79b, 81c を形成すること、並びに配線溝及びビアホールを形成する工程においてはビアホールを形成する箇所のエッチングストップパ層 79c, 81c も除去することが相違する。

【0177】

なお、配線層及びビア層に炭素濃度の高い絶縁膜を配し、エッチングストップパ層を配線層及びビア層に比して炭素濃度の低い絶縁膜としても同様の効果を得られる。さらに、図 25 に示すように、エッチング選択比の十分取れる範囲において、配線層とビア層とに炭素濃度が異なる絶縁膜を適用しても構わない。

【0178】

上記多層配線積層構造も、同一反応室内で、配線層とビア層とを連続的に成膜可能な構造である。従って、炭素濃度の異なる絶縁膜を連続に成膜することで、エッチング選択比とスループットとを同時に改善できる。

【0179】

また、配線層及びビア層の少なくとも一方に上記第一～第三のいずれかの実施形態にかかる多孔質絶縁膜を用い、エッチングストップパ層を例えば無機絶縁膜としても、多層配線全体の実効的な比誘電率を低減するのに有効である。

【0180】

〔第六の実施形態〕

第六の実施形態として、多層配線構造において他の半導体材料との密着性を向上させるための層として上記第一～第三の実施形態にかかる絶縁膜を適用した MOSFET デバイスについて説明する。

【0181】

図 26 は、MOSFET デバイスにおける多層配線構造の一例を模式的に示した断面図である。

配線層及びビア層の上下界面に、層中心部に比して炭素濃度を变化させた絶縁膜を段階的又は連続的に挿入した構造を作製した。該層間絶縁膜の上部及び下部に接する半導体材料との界面付近のみ組成を制御し、上下界面における密着性を向上することが可能である。

【0182】

図26に示す多層配線積層構造を形成する手順は、上記第四の実施形態において説明した手順とほぼ同様である。ただし、第一層目層間絶縁膜75を形成する際には、銅拡散バリア膜74を形成したら、密着性強化層95を形成してから第一層目多孔質絶縁膜75aを形成し、その後密着性強化層95を形成してから第一層目ハードマスク75bを形成する。そして、配線溝を形成する工程においては、配線溝形成箇所の密着性強化層95も除去する。

また、銅拡散バリア膜78とビア層間絶縁膜79a、81aとの間、ビア層間絶縁膜79a、81aとエッチングストッパ層78との間、エッチングストッパ層78と配線層間絶縁膜79b、81bとの間にそれぞれ密着性強化層95を設けており、配線溝やビアホールを形成する際には、これらを形成する箇所の密着性強化層95も除去する。

【0183】

原料として、分子中に環状シリカ骨格を有し且つ該環状シリカ骨格に少なくとも一つの不飽和炭化水素基が結合されている有機シリカ化合物と、分子中に直鎖状シリカ骨格を有し且つ該直鎖状シリカ骨格に少なくとも一つの不飽和炭化水素基が結合されている直鎖状有機シリカ化合物とを用いることで、他の半導体材料との界面に存在する酸素やシリコン等の極性元素の面密度や他の半導体材料との接触界面における急激な組成変化といった界面の密着性を低減させる要素を緩和するように組成を容易に制御可能である。従って、該絶縁膜が他の半導体材料と接する上下界面付近または一方の界面付近の膜組成を、段階的又は連続的に変化させ、接する半導体材料との密着性を向上させるように制御することが可能となる。

【0184】

また、図26は、配線層及びビア層の全ての界面について段階的に炭素濃度を制御し、密着性を向上させた構造の一例であるが、全ての界面について段階的に炭素濃度を制御して密着性を向上させる必要はなく、一部の界面のみに適用しても十分な効果を得られる。

【0185】

さらに、配線層とビア層との界面において、配線層とビア層とのエッチング選択比を十分に得られるように界面組成を制御し、この組成制御層をエッチングストッパ層として利用することも、スループットの向上、プロセス制御性、密着性向上の観点から非常に有効な手段である。

【0186】

【第七の実施形態】

本発明を好適に実施した第七の実施形態として、上記第一～第三の実施形態にかかる絶縁膜を配線層及びビア層に用いたシングルダマシン配線構造のMOSFETデバイスについて説明する。図27は、MOSFETデバイスにおける多層配線構造の一例を模式的に示した断面図である。本実施形態にかかるMOSFETデバイスは、層間絶縁膜に多孔質絶縁膜を適用することで、多層配線の実効的な比誘電率を低減することが可能である。

【0187】

上記構造の多層配線構造を形成する手順について説明する。シリコン基板70にMOSFETデバイスを形成してから、第一層目銅配線77を形成するまでの手順は第四の実施形態と同様である。

【0188】

第一層目銅配線77を形成し終わったら、その上に銅拡散バリア膜78を形成し、さらに第一ビア層間絶縁膜79aを形成し、またさらに第二ビア層間絶縁膜ハードマスク79dを形成する。第二ビア層間絶縁膜ハードマスク79dを形成したら、この上にPR膜を形成する。ビアパターンに合わせてPR膜を露光しこれを現像することによって、のちに第

ービア85が形成される部分のみPR膜を除去する。その後、PR膜をマスクとしてドライエッチングを行って第二ビア層間絶縁膜ハードマスク79d、第一ビア層間絶縁膜79a及び銅拡散バリア層78を部分的に除去し、マスクされていない部分ビアホールを形成する。

【0189】

次に、形成したビアホールの内部を含むMOSFETデバイスの全面に、銅拡散バリア金属83及び銅膜を形成し、これらの余剰分をCMPによって除去することで第一ビア85を形成する。

【0190】

第一ビア85を形成し終えたら、その上に銅拡散バリア膜78を形成し、さらに第二配線層間絶縁膜79bを形成し、またさらに第二配線層間絶縁膜ハードマスク79eを形成する。第二配線層間絶縁膜ハードマスク79eを形成したら、この上にPR膜を形成する。配線パターンに合わせてPR膜を露光しこれを現像することによって、のちに第二層目銅配線80が形成される部分のみPR膜を除去する。その後、PR膜をマスクとしてドライエッチングを行って第二配線層間絶縁膜ハードマスク79e、第二配線層間絶縁膜79b及び銅拡散バリア層78を部分的に除去し、マスクされていない部分に配線溝を形成する。

【0191】

次に、形成した配線溝の内部を含むMOSFETデバイスの全面に、銅拡散バリア金属83及び銅膜を形成し、これらの余剰分をCMPによって除去することで第二層目銅配線80を形成する。

【0192】

第二層目銅配線80を形成し終えたら、その上に銅拡散バリア膜78を形成し、さらに第二ビア層間絶縁膜81aを形成し、またさらに第三ビア層間絶縁膜ハードマスク81dを形成する。第三ビア層間絶縁膜ハードマスク81dを形成したら、この上にPR膜を形成する。ビアパターンに合わせてPR膜を露光しこれを現像することによって、のちに第二ビア86が形成される部分のみPR膜を除去する。その後、PR膜をマスクとしてドライエッチングを行って第三ビア層間絶縁膜ハードマスク81d、第二ビア層間絶縁膜81a及び銅拡散バリア層78を部分的に除去し、マスクされていない部分ビアホールを形成する。

【0193】

次に、形成したビアホールの内部を含むMOSFETデバイスの全面に、銅拡散バリア金属84及び銅膜を形成し、これらの余剰分をCMPによって除去することで第二ビア86を形成する。

【0194】

第二ビア86を形成し終えたら、その上に銅拡散バリア膜78を形成し、さらに第三配線層間絶縁膜81bを形成し、またさらに第三配線層間絶縁膜ハードマスク81eを形成する。第三配線層間絶縁膜ハードマスク81eを形成したら、この上にPR膜を形成する。配線パターンに合わせてPR膜を露光しこれを現像することによって、のちに第三層目銅配線82が形成される部分のみPR膜を除去する。その後、PR膜をマスクとしてドライエッチングを行って第三配線層間絶縁膜ハードマスク81e、第三配線層間絶縁膜81b及び銅拡散バリア層78を部分的に除去し、マスクされていない部分に配線溝を形成する。

【0195】

次に、形成した配線溝の内部を含むMOSFETデバイスの全面に、銅拡散バリア金属84及び銅膜を形成し、これらの余剰分をCMPによって除去することで第三層目銅配線82を形成する。

【0196】

その後、層間絶縁膜及び銅拡散バリア層の形成、配線溝及びビアホールの形成、並びに配線及びビアの形成といった工程を繰り返し実行することで図示するような多層配線構造

が形成される。

【0197】

なお、さらに多層化した構成とする場合には、層間絶縁膜及び銅拡散バリア層の形成、配線溝及びビアホールの形成、並びに配線及びビアの形成といった工程を繰り返し実行すればよい。

【0198】

本実施形態では、配線層とビア層とに上記第一～第三の実施形態にかかる多孔質絶縁膜を用いているが、配線層及びビア層いずれかのみ、上記第一～第三のいずれかの実施形態にかかる多孔質絶縁膜を用いても、実効的な比誘電率を低減するのに有効である。

【0199】

さらに、上記第一～第三の実施形態にかかる絶縁膜を段階的又は連続的に積層し、上層の絶縁膜をハードマスクとして用いても、密着性の向上、多層配線全体の実効的な比誘電率の低減に有効である。

【0200】

〔第八の実施形態〕

本発明を好適に実施した第八の実施形態として、上記第一～第三の実施形態にかかる絶縁膜配線層及びビア層に用いたシングルダマシン配線構造のMOSFETデバイスについて説明する。図28は、MOSFETデバイスにおける多層配線構造の一例を模式的に示した断面図である。

【0201】

図28に示す多層配線積層構造を形成する手順は、上記第七の実施形態において説明した手順とほぼ同様である。ただし、配線溝やビアホールを形成した後で、これらの側壁面に側壁保護膜87を形成してから銅拡散バリア膜78を形成することが異なる。

【0202】

さらに、配線溝及びビアホールの側壁部に、10nm厚以下の保護膜を形成した。多孔質絶縁膜をドライエッチングすると、エッチング後の配線溝側壁部には多孔質絶縁膜、すなわち空孔が露出する。このとき、露出した空孔には、エッチングやアッシング時にガスが侵入又は吸着したり、洗浄工程において水分が侵入又は吸着したりする。これらは、MOSFETデバイスの信頼性の劣化や、絶縁膜の比誘電率の上昇を誘発する一因と成りうる。したがって、ガス成分や水分が空孔中に侵入したり吸着したりすることをなるべく少なくすることが肝要である。

【0203】

本実施形態では、配線溝やビアホールの側壁部に、原料としてジビニルシロキサンベンゾシクロブテンモノマーを用いたプラズマ重合により、10nm厚以下の保護膜(BCB膜)を形成した。これにより、配線溝やビアホールの側壁部に露出した空孔を塞ぎ、ガス成分や水分が空孔内へ侵入したり吸着したりすることを防止することが可能となった。

【0204】

本実施形態では、配線層及びビア層のいずれにも、保護膜を形成しているが、配線層及びビア層のいずれかのみを用いても良い。

【0205】

なお、上記各実施形態は本発明の好適な実施の一例であり、本発明はこれらに限定されることはない。例えば、上記の各実施形態では、原料を気化し、気相中で絶縁膜を成長させた例について示しているが、塗布法により同様に成膜を行っても低誘電率な多孔質絶縁膜を得ることができる。

また、上記の説明は、反応室内でシャワーヘッドにRF電力を印加してプラズマ化する場合を例に行ったが、反応室外で予めプラズマ化を行い、これを反応室内に導入する構成(即ち、リモートプラズマシステム)としても上記各実施形態と同様の絶縁膜やMOSFETデバイスを得られる。

また、上記第四～第八の実施形態においては、半導体装置の一例としてMOSFETをあげて説明したが、この他の半導体装置にも適用可能であることは言うまでもない。

このように、本発明は様々な変形が可能である。

【図面の簡単な説明】

【0206】

【図1】本発明の絶縁膜の作製方法の実施に利用可能な成膜装置の概略図である。

【図2】本発明の絶縁膜の作製方法の実施に利用される、液体原料の気化供給に利用可能な気化供給システムの概略図である。

【図3】本発明の絶縁膜の作製方法の実施に利用される、固体原料の気化供給に利用可能な気化供給システムの概略図である。

【図4】第一の実施形態にかかる絶縁膜の、成膜速度のRF電力依存性を示す図である。

【図5】第一の実施形態にかかる絶縁膜の、比誘電率のRF電力依存性を示す図である。

【図6】第一の実施形態にかかる絶縁膜の、RF電力200Wにおける成膜速度の原料流量依存性を示す図である。

【図7】第一の実施形態にかかる絶縁膜の、RF電力200Wにおける比誘電率の原料流量依存性を示す図である。

【図8】第一の実施形態にかかる絶縁膜の、RF電力200Wにおける成膜速度の反応室圧力依存性を示す図である。

【図9】第一の実施形態にかかる絶縁膜の、RF電力200Wにおける比誘電率の反応室圧力依存性を示す図である。

【図10】第一の実施形態にかかる絶縁膜の、フーリエ変換赤外分光分析結果を示す図である。

【図11】第一の実施形態にかかる絶縁膜の、小角X線分析によるポア（空孔）分布分析結果を示す図である。

【図12】第一の実施形態に記載の絶縁膜の、RF電力200Wにおける電流電圧特性の原料流量依存性を示した図である。

【図13】第二の実施形態にかかる絶縁膜の、成膜速度のN₂O添加量依存性を示す図である。

【図14】第二の実施形態にかかる絶縁膜の、成膜速度の希釈ヘリウムガス流量依存性を示す図である。

【図15】第二の実施形態にかかる絶縁膜の、フーリエ変換赤外分光分析結果を示す図である。

【図16】第二の実施形態にかかる絶縁膜の、小角X線分析によるポア（空孔）分布分析結果を示す図である。

【図17】第二の実施形態にかかる絶縁膜の、比誘電率のN₂O添加量依存性を示す図である。

【図18】第二の実施形態にかかる絶縁膜の、電流電圧特性のN₂O添加量依存性を示した図である。

【図19】第三の実施形態にかかる絶縁膜の、成膜速度の原料供給比、N₂O添加量依存性を示す図である。

【図20】第三の実施形態にかかる絶縁膜の、比誘電率の原料供給比、N₂O添加量依存性を示す図である。

【図21】第三の実施形態にかかる絶縁膜の、ラザフォード後方散乱／水素前方散乱法による組成分析結果の、原料供給比依存性を示した図である。

【図22】第三の実施形態にかかる絶縁膜の、成膜シーケンスを概略的に示した図である。

【図23】第四の実施形態にかかるMOSFETデバイスにおける、デュアルゲマシンの配線構造の模式図である。

【図24】第五の実施形態にかかるMOSFETデバイスにおける、デュアルゲマシンの配線構造の模式図である。

【図 25】第五の実施形態にかかる MOSFET デバイスにおける、デュアルダマシ
ン配線構造の模式図である。

【図 26】第六の実施形態にかかる MOSFET デバイスにおける、デュアルダマシ
ン配線構造の模式図である。

【図 27】第七の実施形態にかかる MOSFET デバイスにおける、シングルダマシ
ン配線構造の模式図である。

【図 28】第八の実施形態にかかる MOSFET デバイスにおける、銅配線側壁部に
～10nm の保護膜を設けたシングルダマシン配線構造の模式図である。

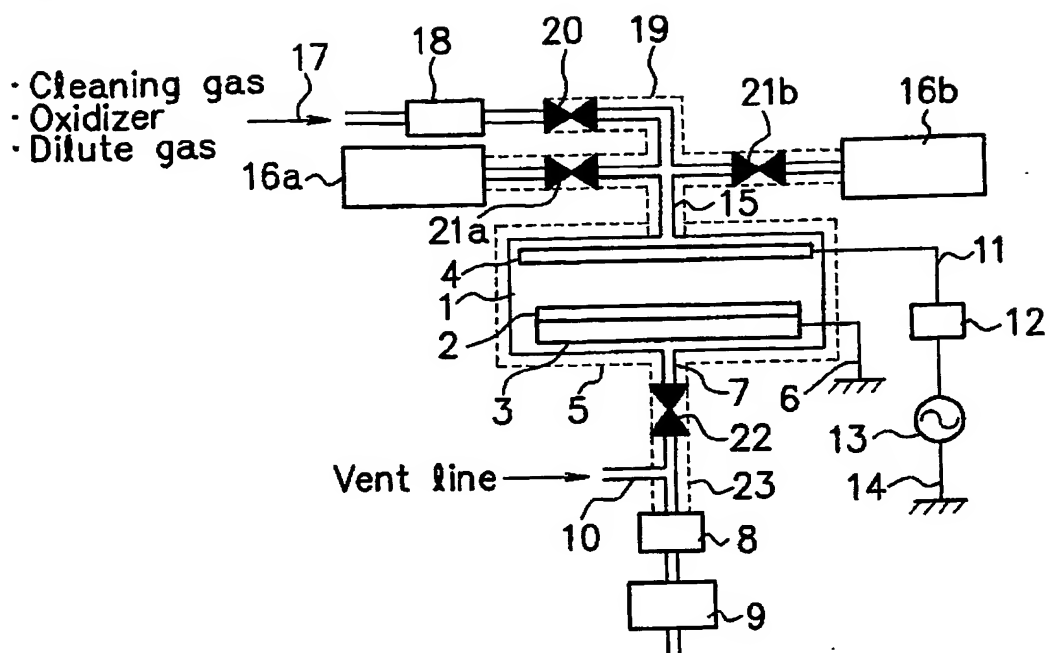
【符号の説明】

【0207】

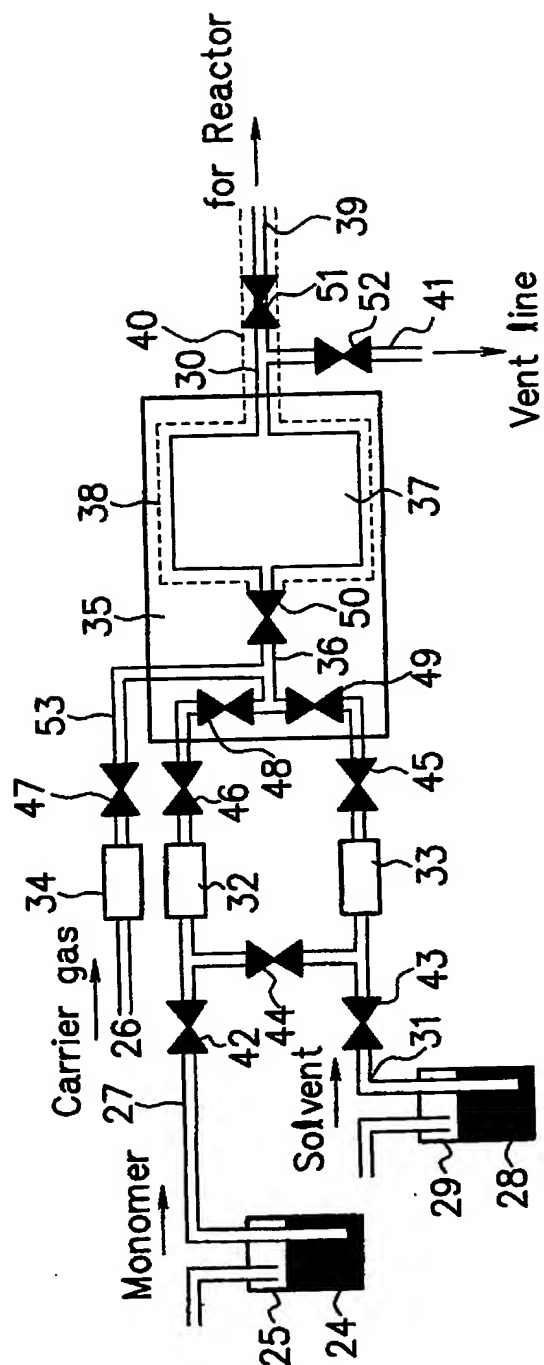
- 1 反応室
- 2 半導体基板
- 3 基板加熱部
- 4 シャワーヘッド
- 5 アース線
- 6 反応室加熱ヒータ
- 7 排気配管
- 8 冷却トラップ
- 9 真空ポンプ
- 10 廃液配管
- 11 RF ケーブル
- 12 マッチングコントローラ
- 13 RF 電源
- 14 アース線
- 15 気化原料供給配管
- 16 a、16 b 気化供給システム
- 17 クリーニングガス、酸化ガス、希釈ガス
- 18 流量コントローラ
- 19 ガス配管
- 20、21 a、21 b、22 バルブ
- 23 排気配管ヒータ
- 24 液体モノマー原料
- 25 原料タンク
- 26 キャリアガス
- 27 原料供給配管
- 28 洗浄溶媒
- 29 洗浄溶媒タンク
- 30 気化原料供給配管
- 31 洗浄溶媒供給配管
- 32 原料流量制御器
- 33 溶媒流量制御器
- 34 キャリアガス流量制御器
- 35 気化制御器
- 36 原料・キャリアガス供給配管
- 37 気化室
- 38 ヒータ
- 39 気化原料供給配管
- 40 ヒータ
- 41 廃液配管
- 42～52 バルブ

- 53 キャリアガス
- 54 流量制御器
- 55 バルブ
- 56 キャリアガス供給配管
- 57 ヒータ
- 58 気化室
- 59 原料
- 60 気化原料供給配管
- 61 バルブ
- 62 流量制御器
- 63 バルブ
- 64 気化原料供給配管
- 65 ヒータ
- 66 バルブ
- 67 気化原料供給配管
- 68 バルブ
- 69 廃液配管
- 70 シリコン基板
- 71 MOSFET
- 72 コンタクトプラグ
- 73 無機層間絶縁膜
- 74 銅拡散バリア膜
- 75 第一層目層間絶縁膜
- 75 a 第一層目多孔質絶縁膜
- 75 b 第一層目ハードマスク
- 76 第一層目銅拡散バリア金属
- 77 第一層目銅配線
- 78 銅拡散バリア膜
- 79 第二層目層間絶縁膜
- 79 a 第一ビア層間絶縁膜
- 79 b 第二配線層間絶縁膜
- 79 c エッチングストッパ膜
- 79 d 第二ビア層間絶縁膜ハードマスク
- 79 e 第二配線層間絶縁膜ハードマスク
- 80 第二層目銅配線
- 81 第三層目層間絶縁膜
- 81 a 第二ビア層間絶縁膜
- 81 b 第二配線層間絶縁膜
- 81 c エッチングストッパ膜
- 81 d 第二ビア層間絶縁膜ハードマスク
- 81 e 第三配線層間絶縁膜ハードマスク
- 82 第三層目銅配線
- 83、84 銅拡散バリア金属
- 85 第一ビア
- 86 第二ビア
- 87 銅配線側壁保護膜

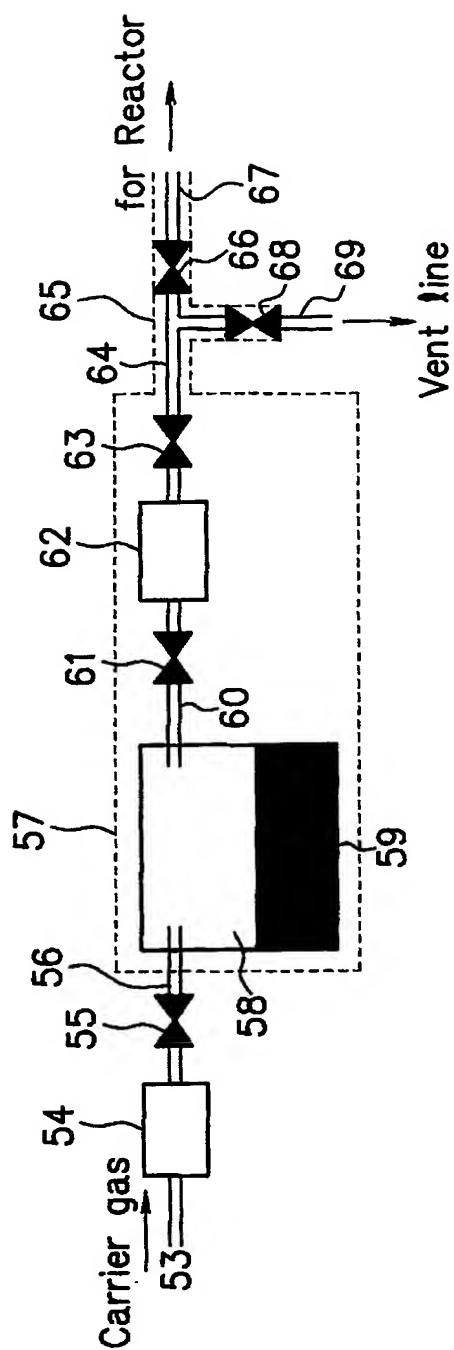
【書類名】 図面
【図 1】



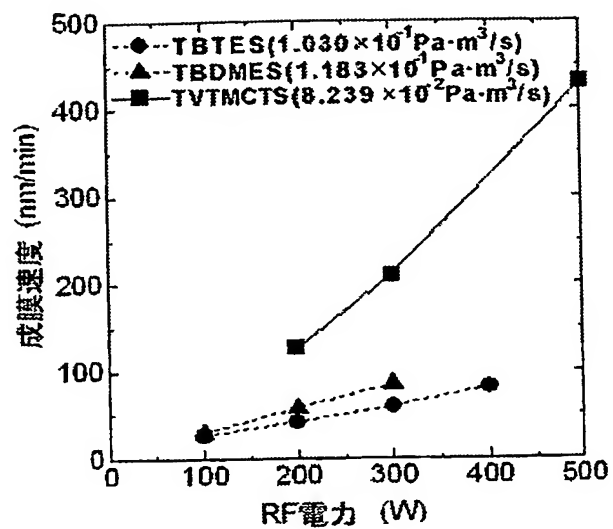
【図 2】



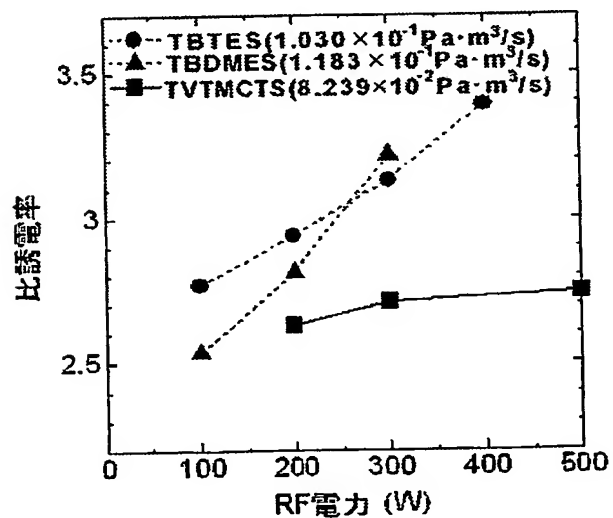
【図 3】



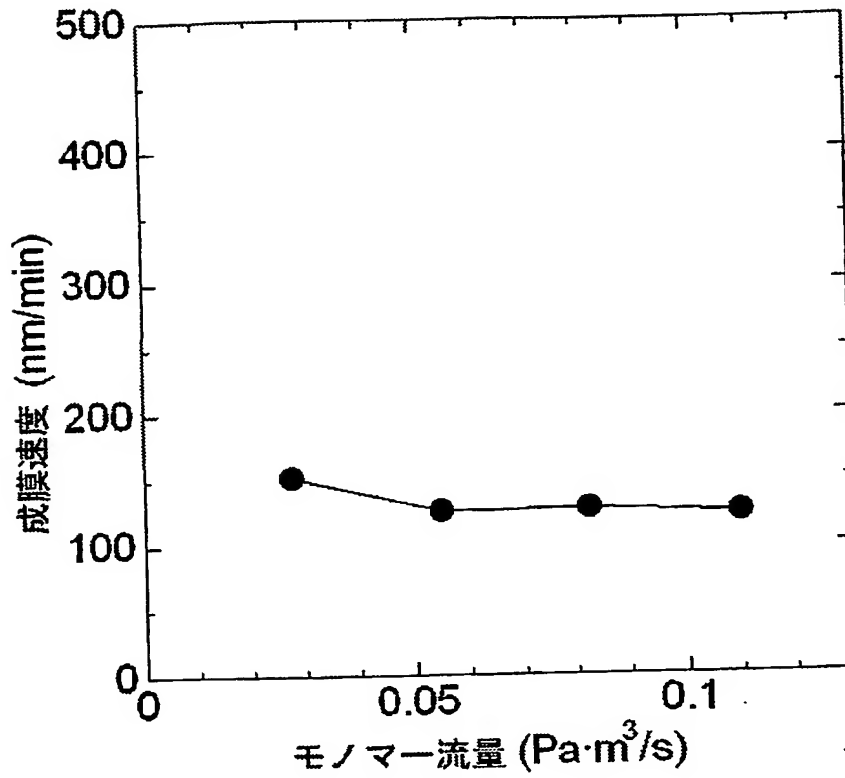
【図 4】



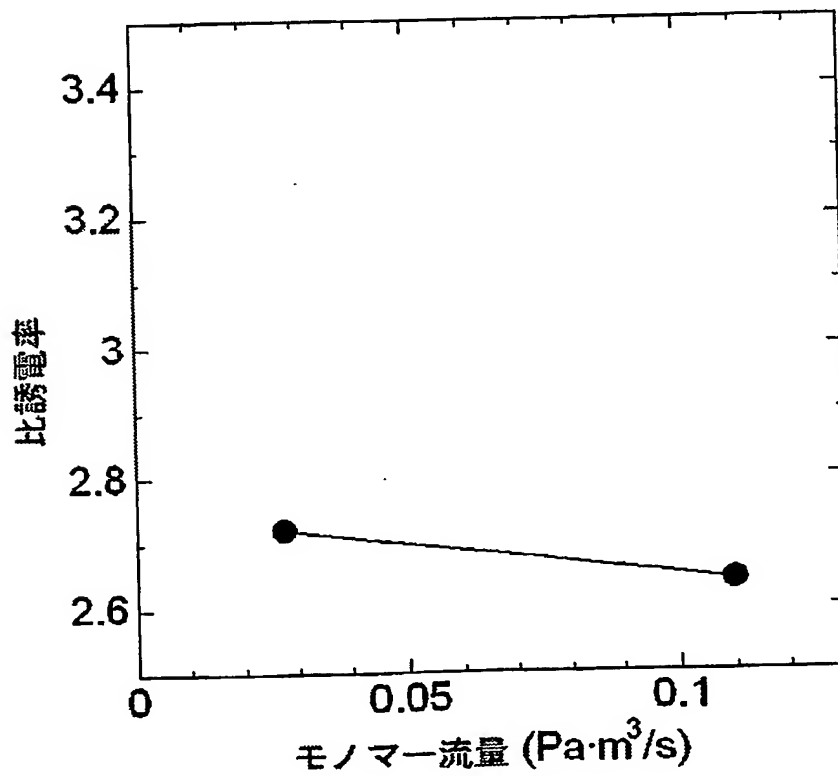
【図 5】



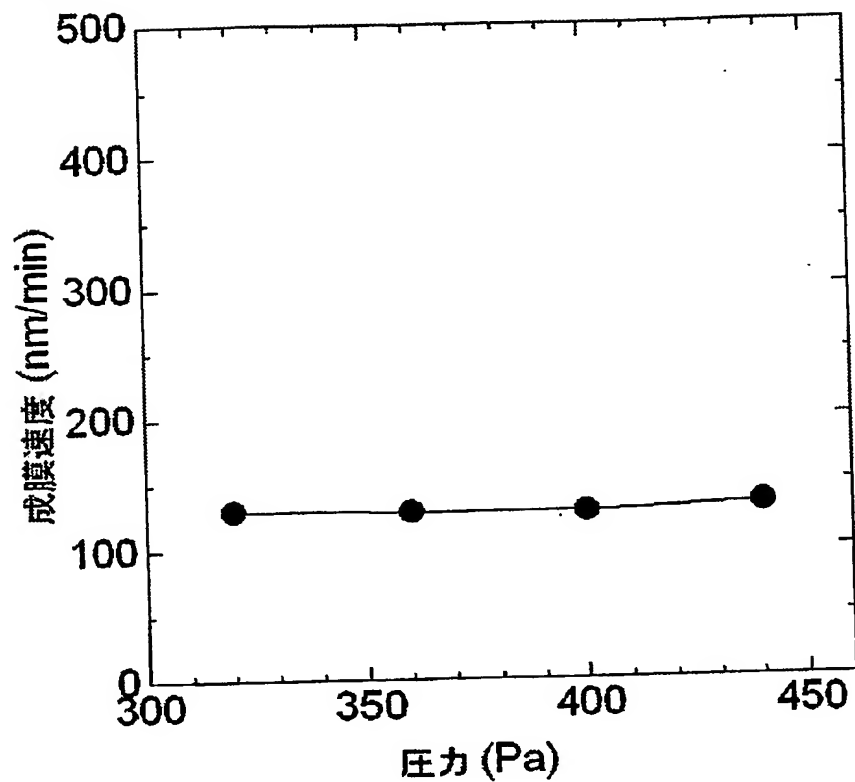
【図6】



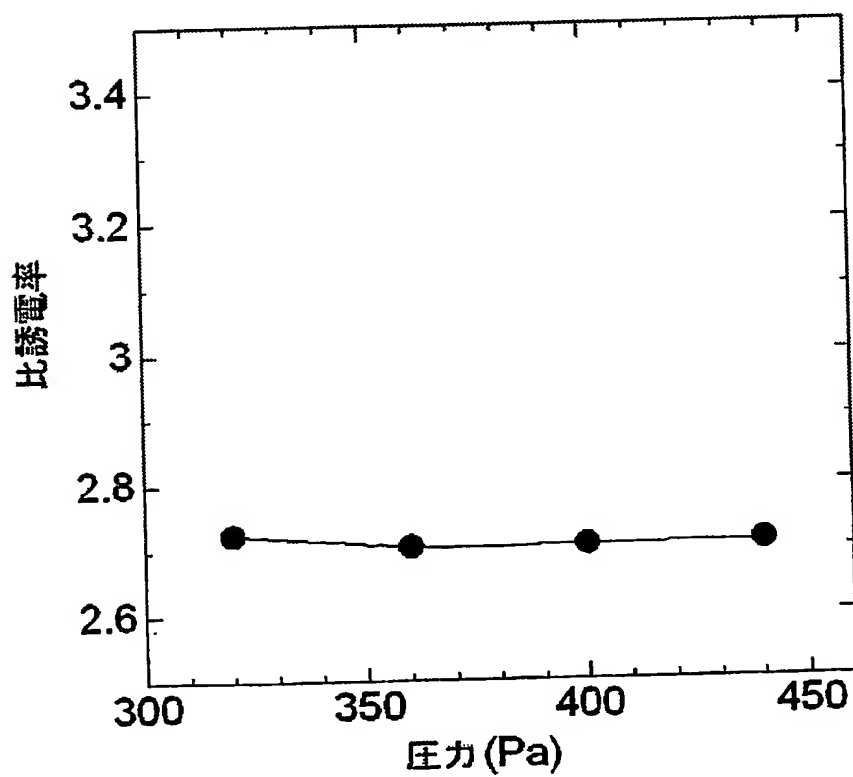
【図7】



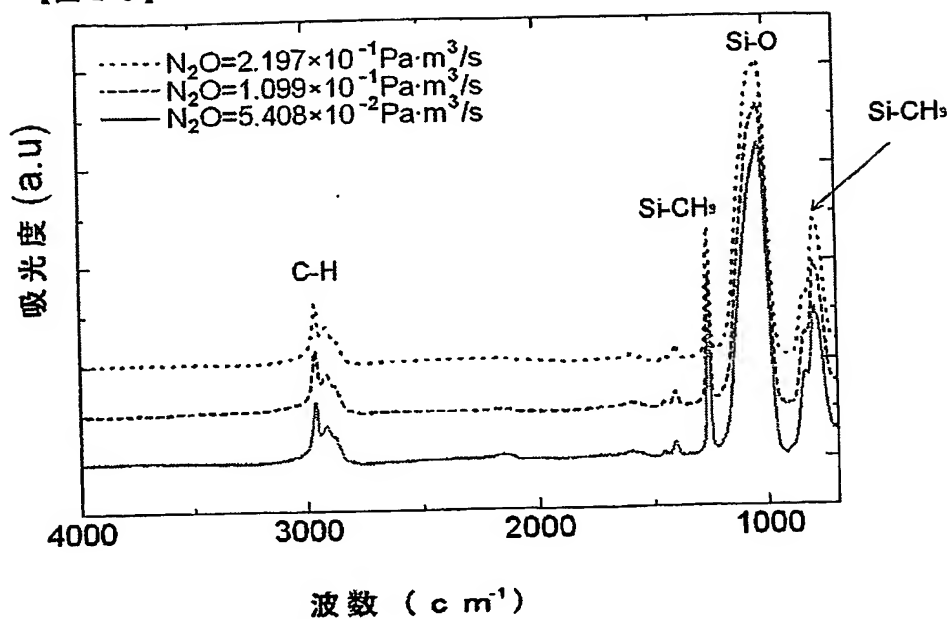
【図 8】



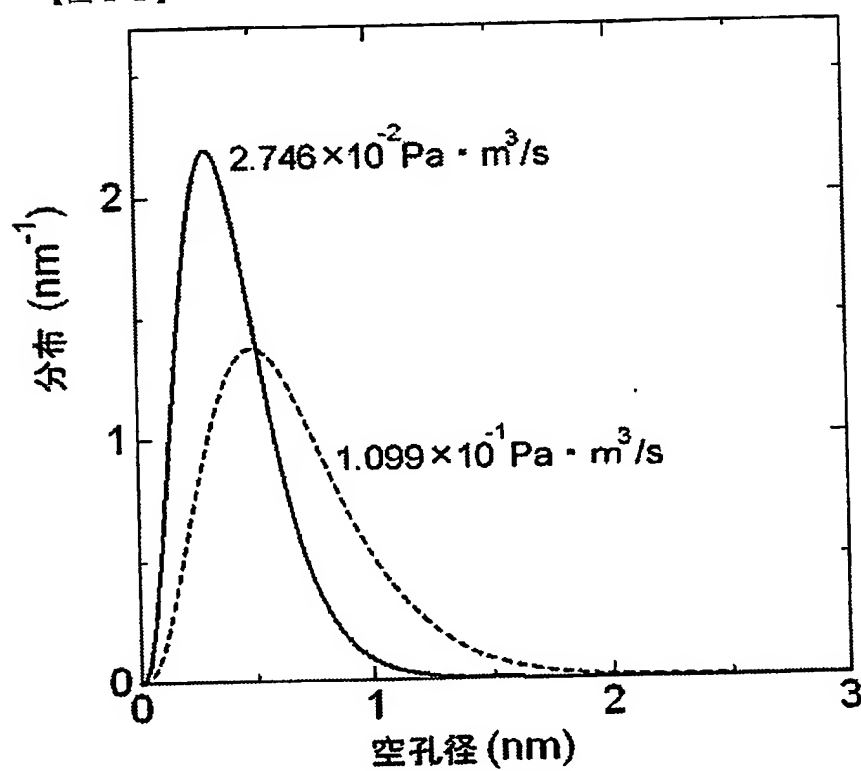
【図 9】



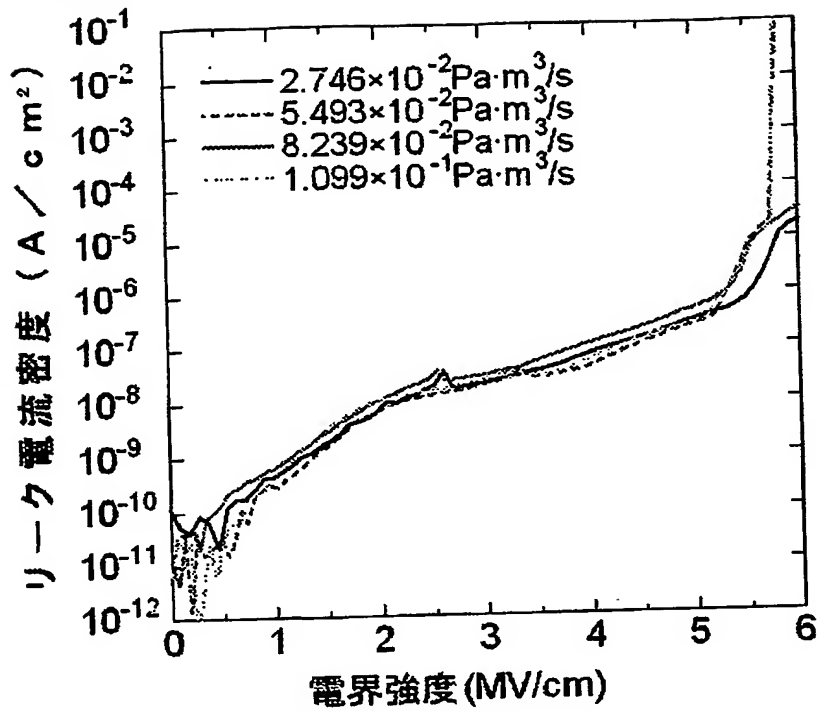
【図10】



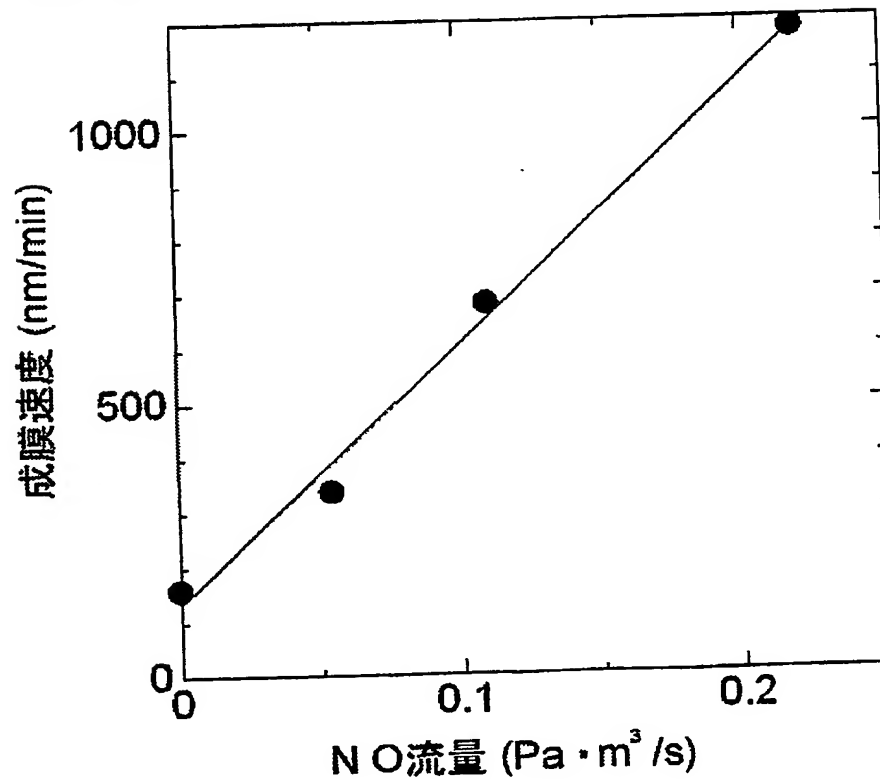
【図11】



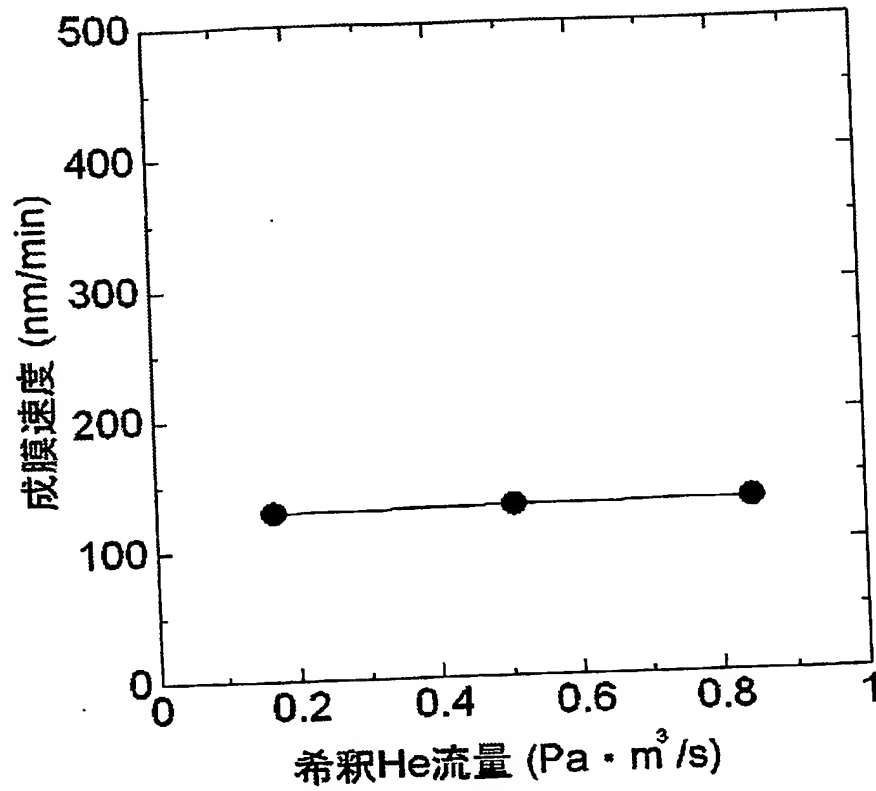
【図12】



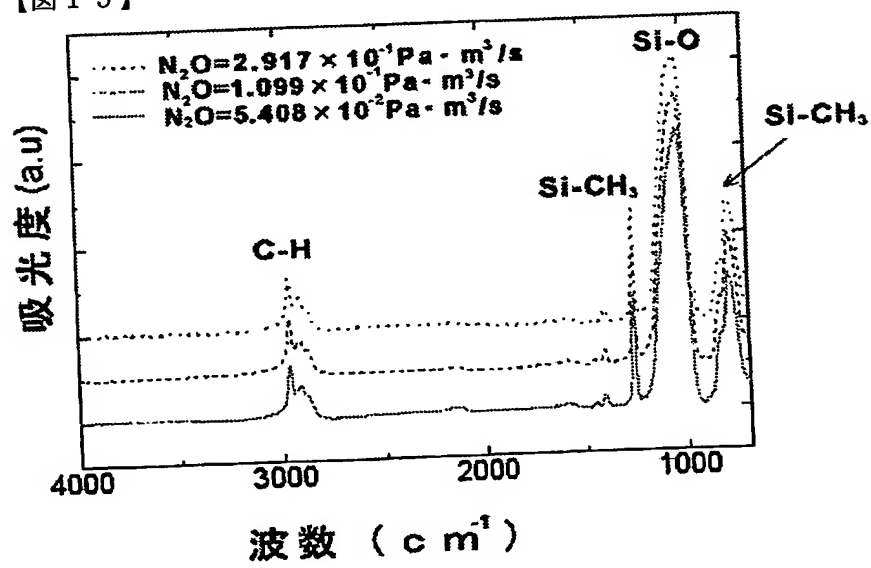
【図13】



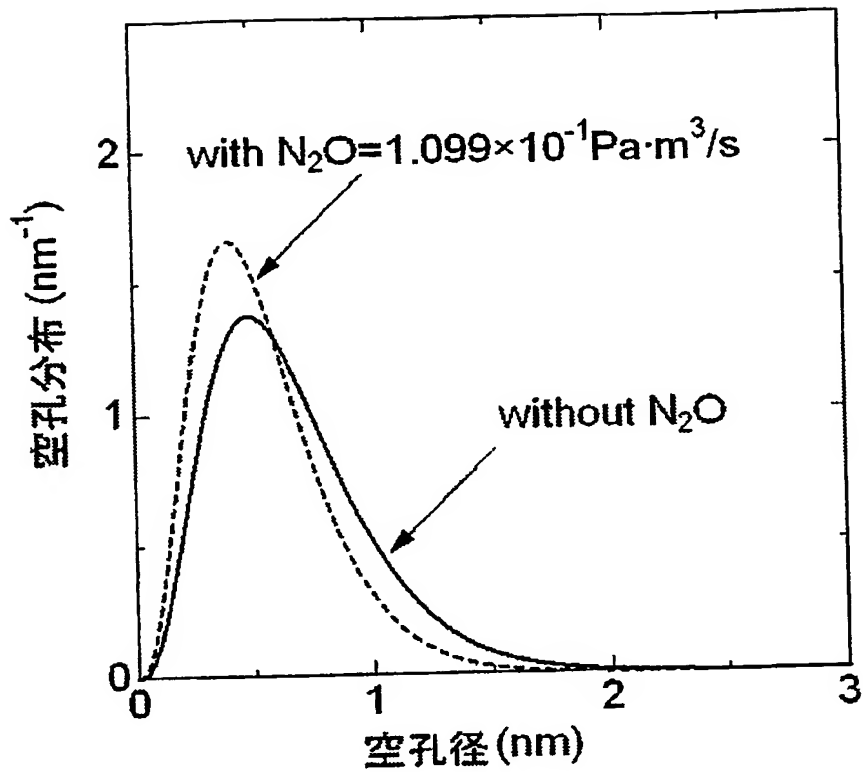
【図14】



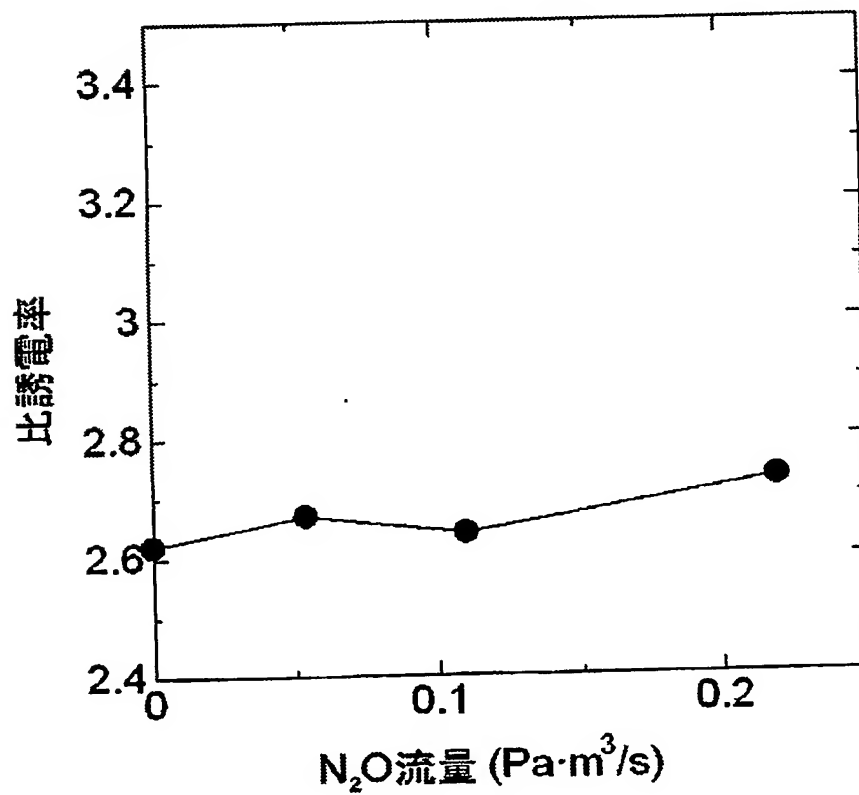
【図15】



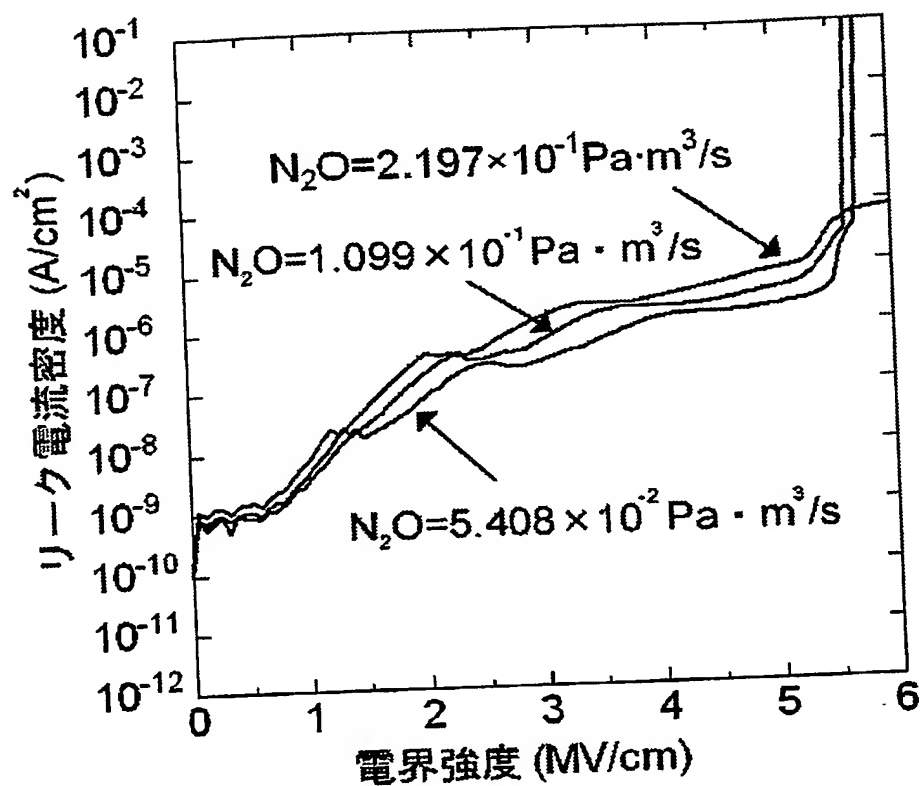
【図16】



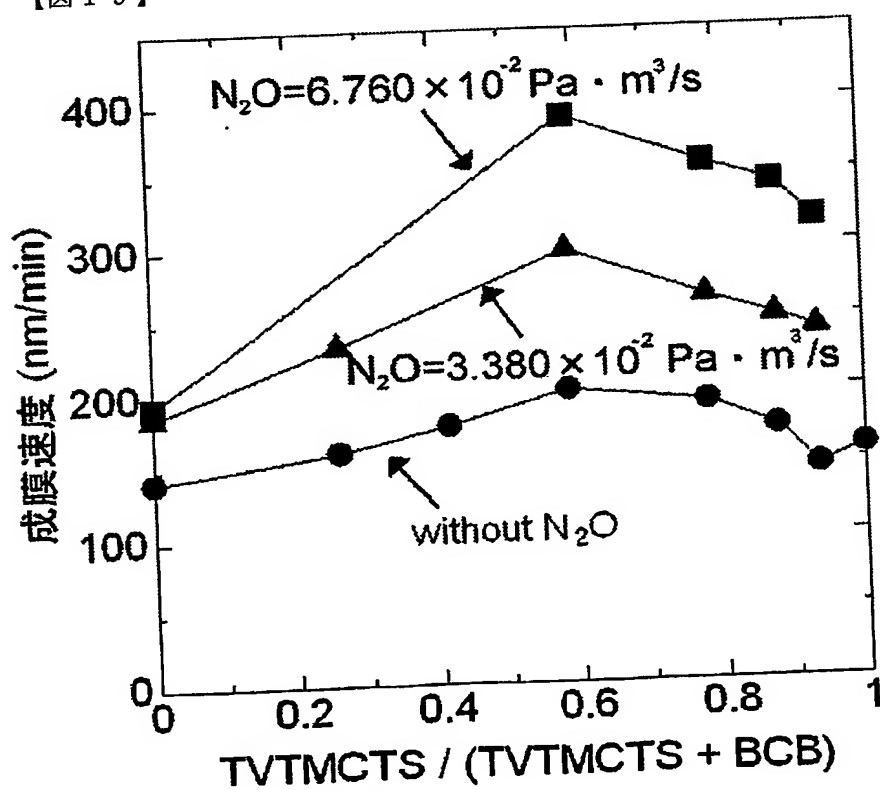
【図17】



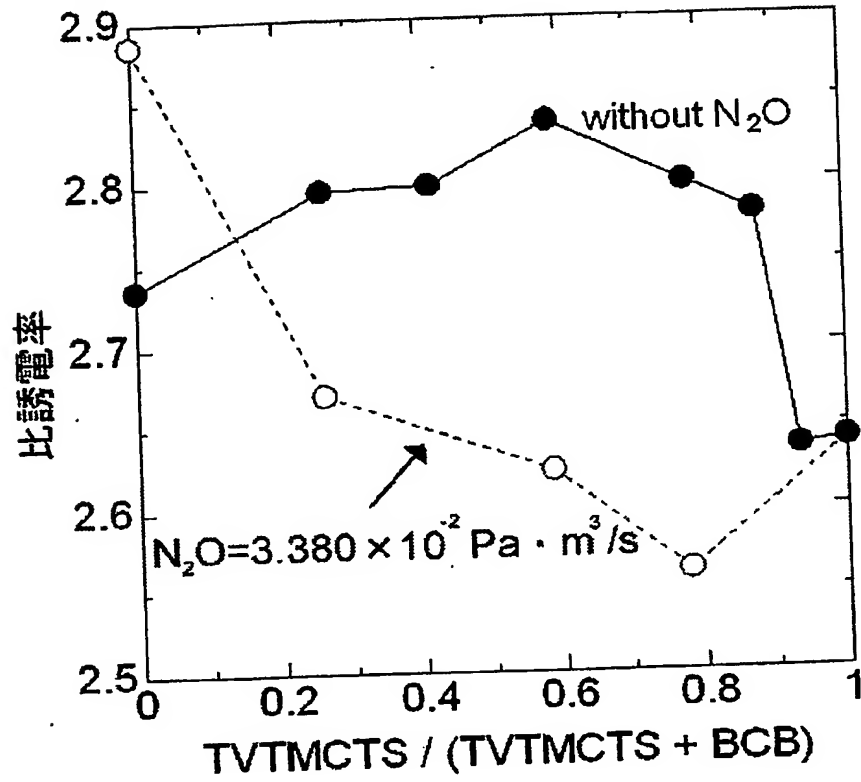
【図18】



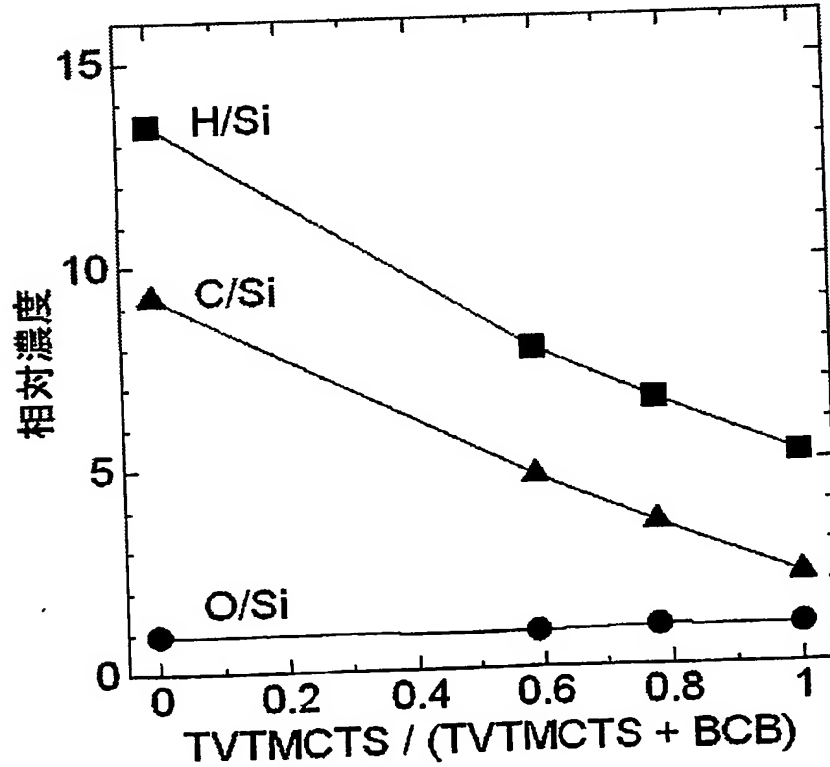
【図19】



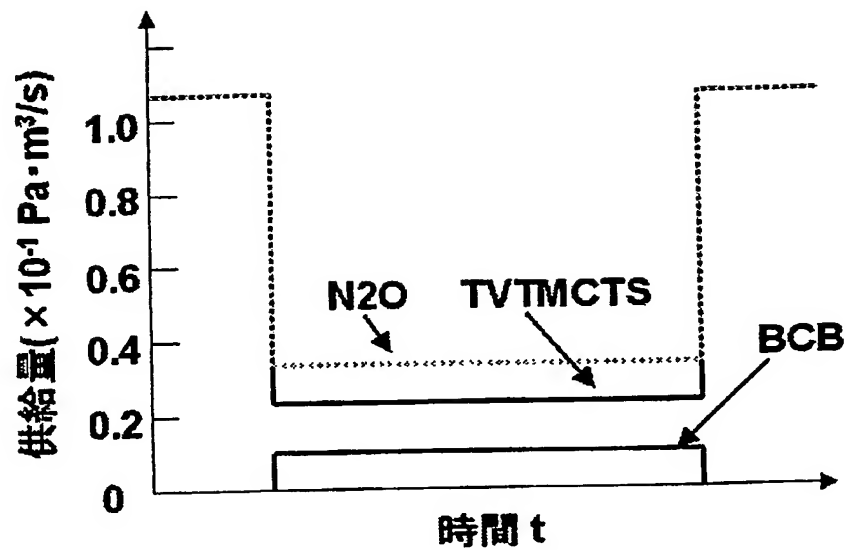
【図 20】



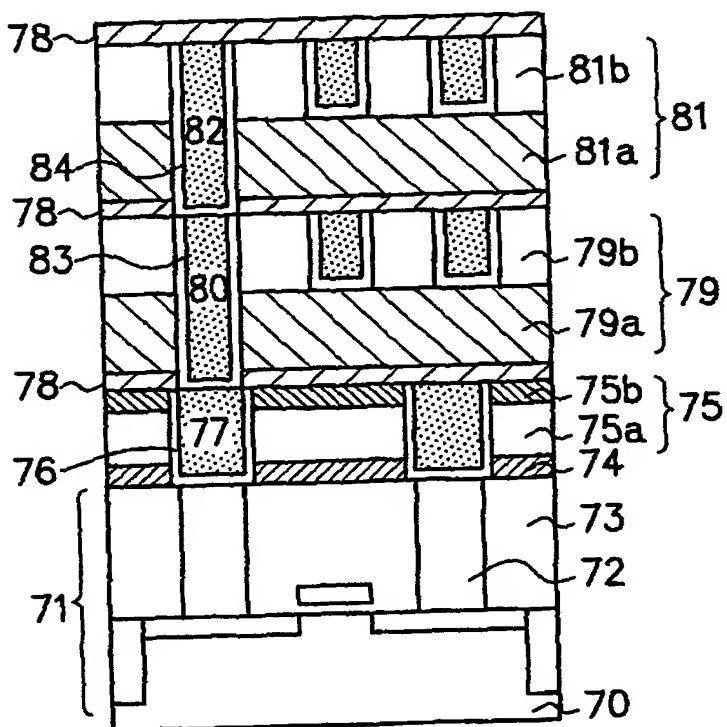
【図 21】



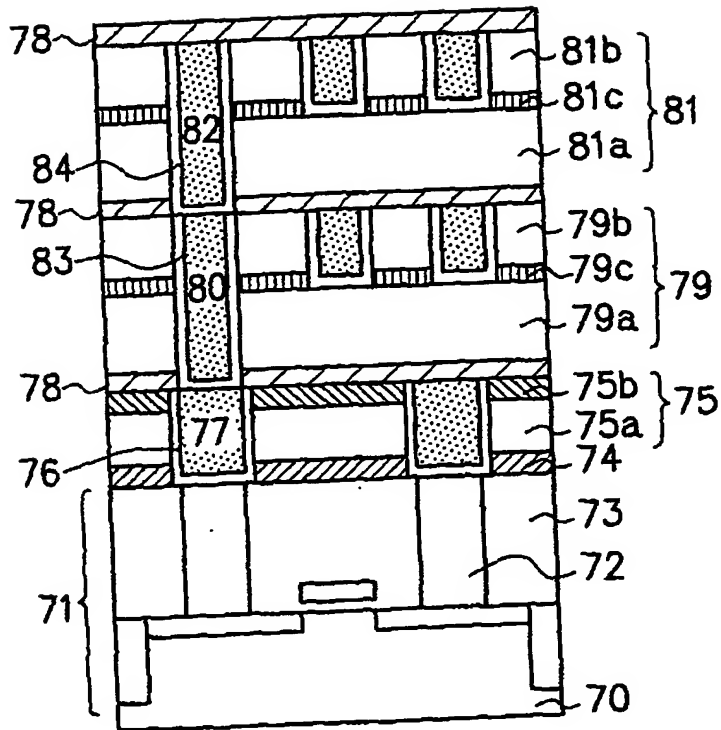
【図 2 2】



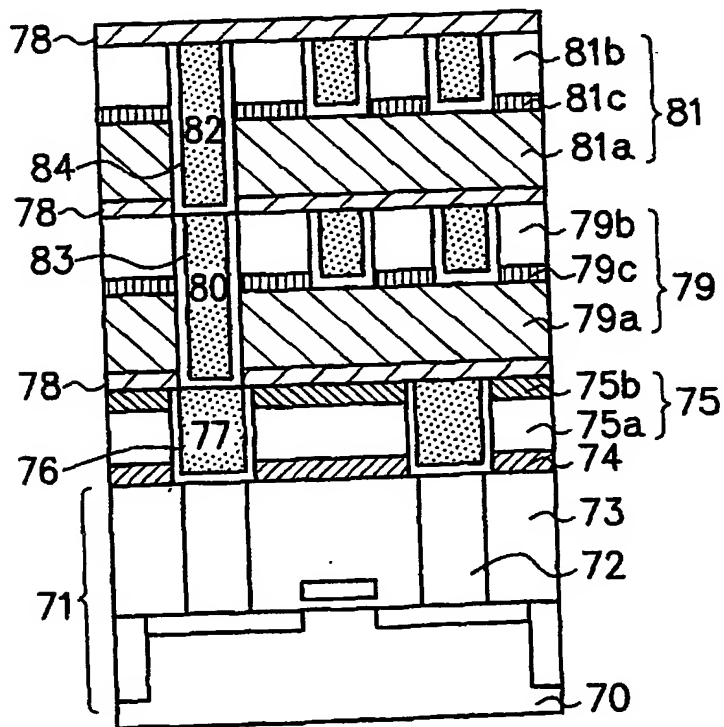
【図 2 3】



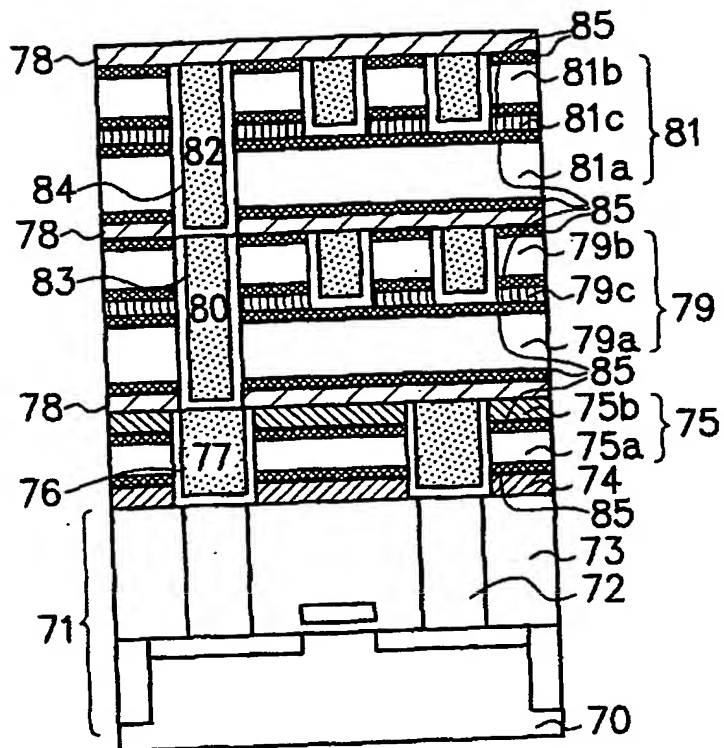
【図24】



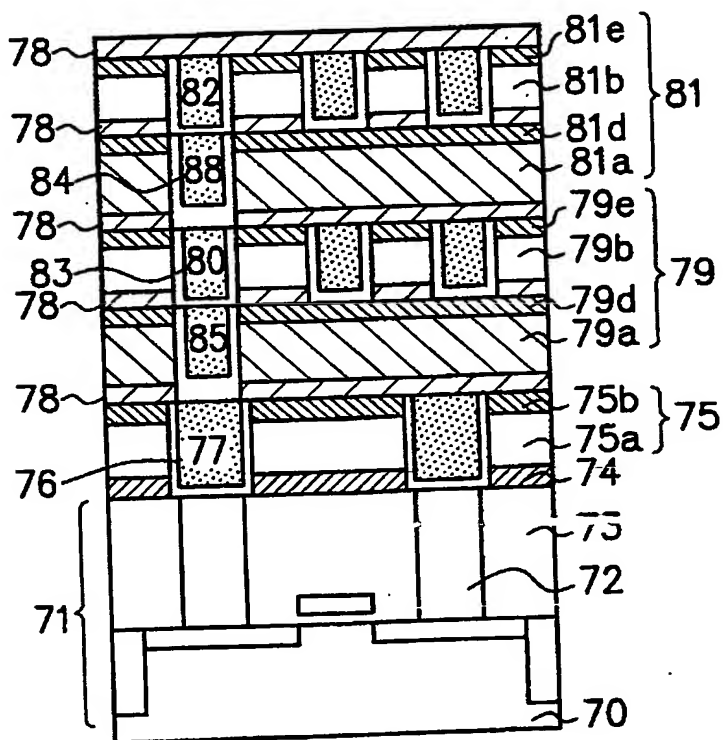
【図25】



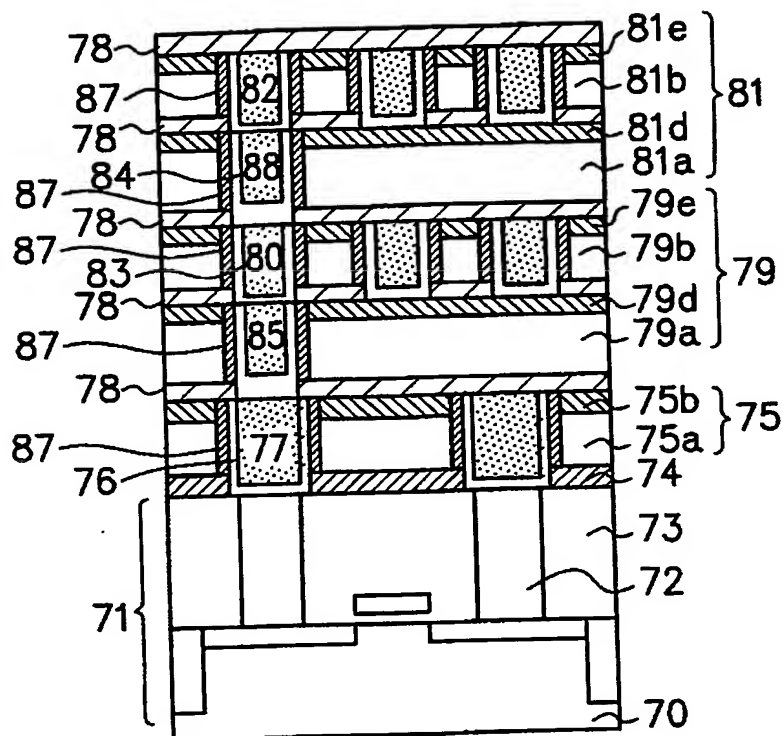
【図 26】



【図 27】



【図 28】



【書類名】 要約書**【要約】**

【課題】 半導体装置を構成する絶縁膜として有効な多孔質絶縁膜の作製方法、該絶縁膜の上下界面に接する半導体材料と高い密着性を有する多孔質絶縁膜の作製方法を提供。

【解決手段】 少なくとも一つ以上の、分子中に環状シリカ骨格を有し且つ該環状シリカ骨格に少なくとも一つ以上の不飽和炭化水素基が結合されている有機シリカ化合物の分子蒸気、を含む気体をプラズマ中に導入し、半導体基板上に多孔質絶縁膜の成長を行う。

【選択図】 図 1

特願 2 0 0 3 - 4 0 0 6 8 3

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 4 2 3 7]

1. 変更新月日

1 9 9 0 年 8 月 2 9 日

[変更新理由]

新規登録

住 所

東京都港区芝五丁目 7 番 1 号

氏 名

日本電気株式会社